



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2015년03월13일

(11) 등록번호 10-1502316

(24) 등록일자 2015년03월09일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

C09K 11/06 (2006.01) C07D 209/82 (2006.01)

H01L 51/50 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2014-0087769

(22) 출원일자 2014년07월11일

심사청구일자 2014년07월11일

(30) 우선권주장

1020140046857 2014년04월18일 대한민국(KR)

(56) 선행기술조사문헌

US7485376 B2

(73) 특허권자

룸엔드하스전자재료코리아유한회사

충청남도 천안시 서북구 3공단1로 56 (백석동)

(72) 발명자

안희춘

경기도 수원시 영통구 영통로 174번길 62

김영광

경기도 수원시 영통구 매영로415번길 46 304호

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

장훈

전체 청구항 수 : 총 9 항

심사관 : 오세주

(54) 발명의 명칭 복수종의 호스트 재료 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자

(57) 요약

본 발명은 복수종의 호스트 재료 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자 에 관한 것이다. 본 발명의 유기 전계 발광 소자는 특정 조합의 복수종의 호스트 화합물을 포함함으로써 높은 발광 효율 및 우수한 수명 특성을 나타낼 수 있다.

(72) 발명자

이수현

경기도 수원시 장안구 수일로 205 105동 1102호

전지송

경기도 수원시 영통구 덕영대로1483번길 97(신동)

이선우

경기도 오산시 오산로 49-5, 104-108

김치석

경기도 화성시 동탄반석로 71 솔빛마을쌍용예가아파트 441동 1201호

박경진

경기도 성남시 중원구 원터로 31

김남균

경기도 용인시 수지구 포은대로 219 서원마을현대아이파크아파트3단지 302동 1801호

최경훈

경기도 화성시 동탄중앙로 189 시범다운마을월드메르디앙반도유보라아파트 337동 801호

심재훈

서울특별시 영등포구 국제금융로 79 한양아파트 H동 407호

조영준

경기도 성남시 분당구 판교로 393 붓들마을이지더원아파트 204동 701호

이경주

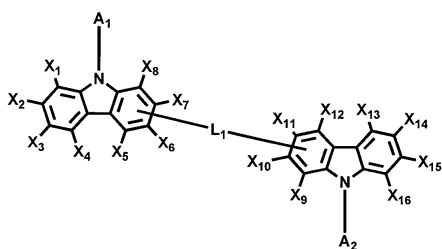
서울특별시 마포구 새창로8길 72 도화현대홈타운아파트 210동 1001호

특허청구의 범위

청구항 1

양극과 음극 사이에 적어도 1층의 발광층을 갖고, 상기 발광층에는 호스트와 인광 도판트를 포함하고, 상기 호스트는 복수종의 호스트 화합물로 구성되고, 상기 복수종의 호스트 화합물 중 적어도 제1 호스트 화합물은 화학식 1로 표시되고, 제2 호스트 화합물은 화학식 2로 표시되는 것인, 유기 전계 발광 소자.

[화학식 1]



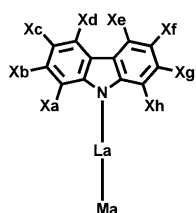
상기 화학식 1에서,

A₁ 및 A₂는 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아릴이고;

L₁은 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아릴렌이고;

X₁ 내지 X₁₆은 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 시아노, 치환 또는 비치환된 (C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된 (C2-C30)알케닐, 치환 또는 비치환된 (C2-C30)알키닐, 치환 또는 비치환된 (C3-C30)시클로알킬, 치환 또는 비치환된 (C6-C60)아릴, 치환 또는 비치환된 (3-30원)헤테로아릴, 치환 또는 비치환된 트리(C1-C30)알킬실릴, 치환 또는 비치환된 트리(C6-C30)아릴실릴, 치환 또는 비치환된 디(C1-C30)알킬(C6-C30)아릴실릴, 또는 치환 또는 비치환된 모노- 또는 디- (C6-C30)아릴아미노이거나; 인접한 치환기끼리 서로 연결되어 치환 또는 비치환된 (C3-C30) 단일환 또는 다환의 지환족 또는 방향족 고리를 형성할 수 있으며, 상기 형성된 지환족 또는 방향족 고리의 탄소 원자는 질소, 산소 및 황으로부터 선택되는 하나 이상의 헤테로원자로 대체될 수 있고;

[화학식 2]



상기 화학식 2에서,

Ma는 치환 또는 비치환된 질소 함유 (5-11원)헤테로아릴이고;

La는 단일 결합, 또는 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아릴렌이고;

Xa 내지 Xh는 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 시아노, 치환 또는 비치환된 (C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된 (C2-C30)알케닐, 치환 또는 비치환된 (C2-C30)알키닐, 치환 또는 비치환된 (C3-C30)시클로알킬, 치환 또는 비치환된 (C6-C60)아릴, 치환 또는 비치환된 (3-30원)헤테로아릴, 치환 또는 비치환된 트리(C1-C30)알킬실릴, 치환 또는 비치환된 트리(C6-C30)아릴실릴, 치환 또는 비치환된 디(C1-C30)알킬(C6-C30)아릴실릴, 또는 치환 또는 비치환된 모노- 또는 디- (C6-C30)아릴아미노이거나; 인접한 치환기끼리 서로 연결되어 치환 또는 비치환된 (C3-C30)단일환 또는 다환의 지환족 또는 방향족 고리를 형성할 수 있으며, 상기 형성된 지환족 또는 방향족 고리의 탄소 원자는 질소, 산소 및 황으로부터 선택되는 하나 이상의 헤테로원자로 대체될 수 있고;

상기 헤테로아틸은 B, N, O, S, P(=O), Si 및 P로부터 선택된 하나 이상의 헤테로원자를 포함한다.

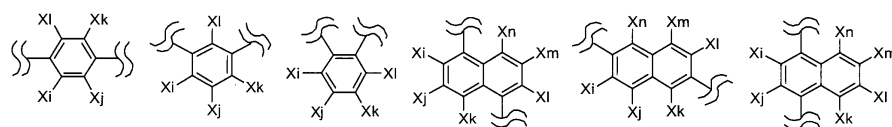
청구항 2

제1항에 있어서, 상기 화학식 1에서 A₁ 및 A₂는 각각 독립적으로 페닐, 비페닐, 터페닐, 나프틸, 플루오레닐, 페난트레닐, 안트라세닐, 인데닐, 트리페닐레닐, 피레닐, 테트라세닐, 페틸레닐, 크라이세닐 및 플루오란테닐로 이루어진 군으로부터 선택되는 것인, 유기 전계 발광 소자.

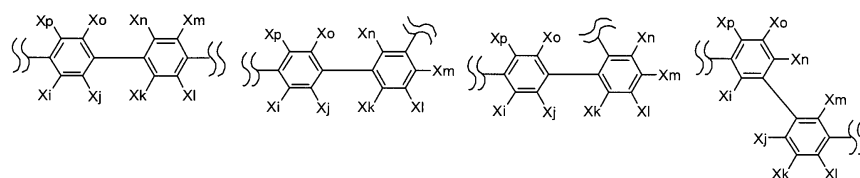
청구항 3

제1항에 있어서, 상기 화학식 1에서 L₁은 하기 화학식 7 내지 19 중 하나로 표시되는 것인, 유기 전계 발광 소자.

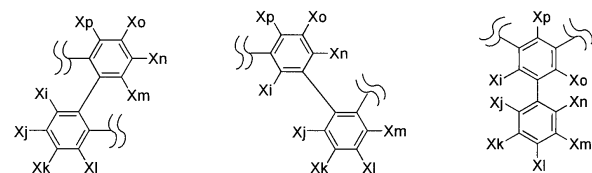
[화학식 7] [화학식 8] [화학식 9] [화학식 10] [화학식 11] [화학식 12]



[화학식 13] [화학식 14] [화학식 15] [화학식 16]



[화학식 17] [화학식 18] [화학식 19]



상기 화학식 7 내지 19에서,

Xi 내지 Xp는 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 시아노, 치환 또는 비치환된 (C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된 (C2-C30)알케닐, 치환 또는 비치환된 (C2-C30)알키닐, 치환 또는 비치환된 (C3-C30)시클로알킬, 치환 또는 비치환된 (C6-C60)아릴, 치환 또는 비치환된 (3-30원)헤테로아틸, 치환 또는 비치환된 트리(C1-C30)알킬실릴, 치환 또는 비치환된 트리(C6-C30)아릴실릴, 치환 또는 비치환된 디(C1-C30)알킬(C6-C30)아릴실릴, 또는 치환 또는 비치환된 모노- 또는 디- (C6-C30)아릴아미노이거나; 인접한 치환기끼리 서로 연결되어 치환 또는 비치환된 (C3-C30) 단일환 또는 다환의 지환족 또는 방향족 고리를 형성할 수 있으며, 상기 형성된 지환족 또는 방향족 고리의 탄소 원자는 질소, 산소, 및 황으로부터 선택되는 하나 이상의 헤테로원자로 대체될 수 있다.

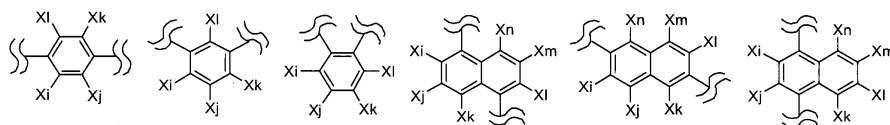
청구항 4

제1항에 있어서, 상기 화학식 2에서 Ma는 피롤릴, 이미다졸릴, 피라졸릴, 트리아진일, 테트라진일, 트리아졸릴, 테트라졸릴, 피리딜, 피라진일, 피리미딘일, 및 피리다진일로 이루어진 군으로부터 선택되는 단일 환계 헤테로아틸이거나, 벤조이미다졸릴, 이소인돌릴, 인돌릴, 인다졸릴, 벤조티아디아졸릴, 퀴놀릴, 이소퀴놀릴, 신놀리닐, 퀴나졸리닐, 나프티리디닐, 및 퀴녹살리닐로 이루어진 군으로부터 선택되는 융합 환계 헤테로아틸인 것인, 유기 전계 발광 소자.

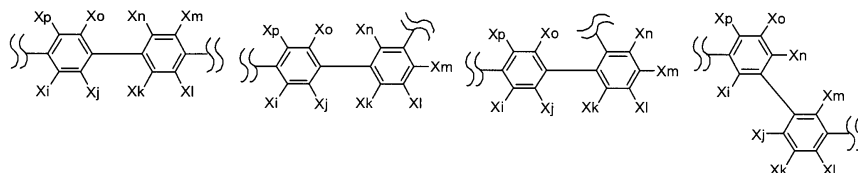
청구항 5

제1항에 있어서, 상기 화학식 2에서 La는 단일 결합이거나, 하기 화학식 7 내지 19 중 하나로 표시되는 것인, 유기 전계 발광 소자.

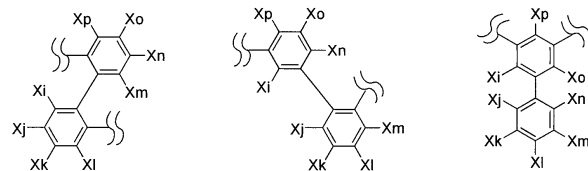
[화학식 7] [화학식 8] [화학식 9] [화학식 10] [화학식 11] [화학식 12]



[화학식 13] [화학식 14] [화학식 15] [화학식 16]



[화학식 17] [화학식 18] [화학식 19]



상기 화학식 7 내지 19에서,

X_i 내지 X_p 는 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 시아노, 치환 또는 비치환된 (C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된 (C2-C30)알케닐, 치환 또는 비치환된 (C2-C30)알키닐, 치환 또는 비치환된 (C3-C30)시클로알킬, 치환 또는 비치환된 (C6-C60)아릴, 치환 또는 비치환된 (3-30원)헤테로아릴, 치환 또는 비치환된 트리(C1-C30)알킬실릴, 치환 또는 비치환된 트리(C6-C30)아릴실릴, 치환 또는 비치환된 디(C1-C30)알킬(C6-C30)아릴실릴, 또는 치환 또는 비치환된 모노- 또는 디- (C6-C30)아릴아미노이거나; 인접한 치환기끼리 서로 연결되어 치환 또는 비치환된 (C3-C30) 단일환 또는 다환의 지환족 또는 방향족 고리를 형성할 수 있으며, 상기 형성된 지환족 또는 방향족 고리의 탄소 원자는 질소, 산소, 및 황으로부터 선택되는 하나 이상의 헤테로원자로 대체될 수 있다.

청구항 6

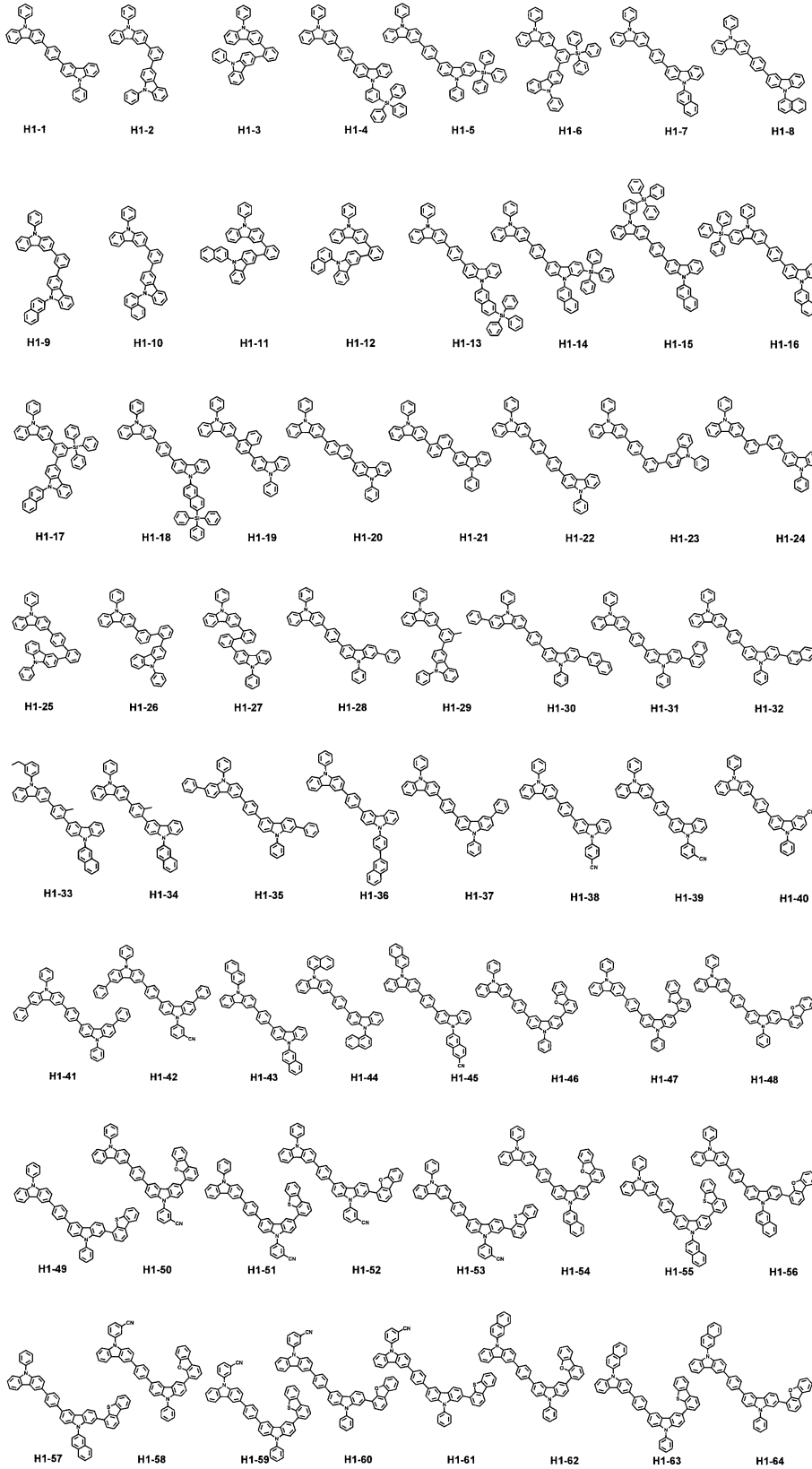
제1항에 있어서, 상기 화학식 2에서 X_a 내지 X_h 는 각각 독립적으로 수소; 시아노; 트리(C6-C10)아릴실릴로 치환 또는 비치환된 (C6-C15)아릴; (C6-C12)아릴 또는 시아노(C6-C12)아릴로 치환 또는 비치환된 (10-20원)헤테로아릴; 또는 비치환된 트리(C6-C10)아릴실릴이거나; 인접한 치환기끼리 서로 연결되어 치환 또는 비치환된 벤젠, 치환 또는 비치환된 인돌, 치환 또는 비치환된 벤조인돌, 치환 또는 비치환된 인덴, 치환 또는 비치환된 벤조푸란, 또는 치환 또는 비치환된 벤조티오펜을 형성하는 것인, 유기 전계 발광 소자.

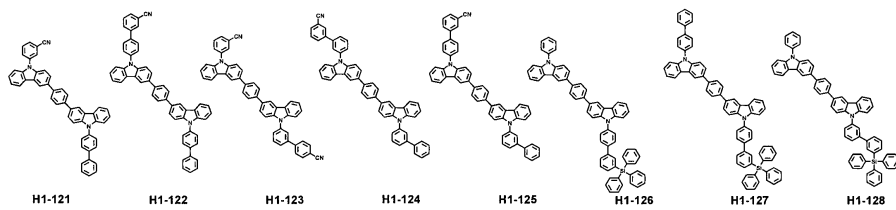
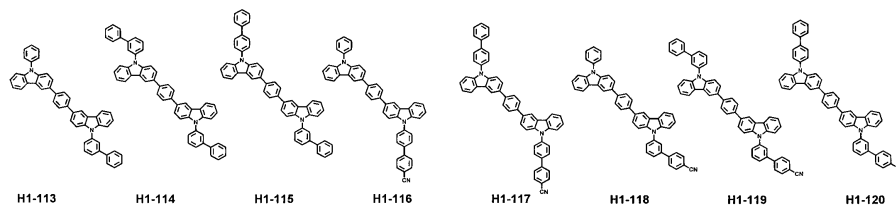
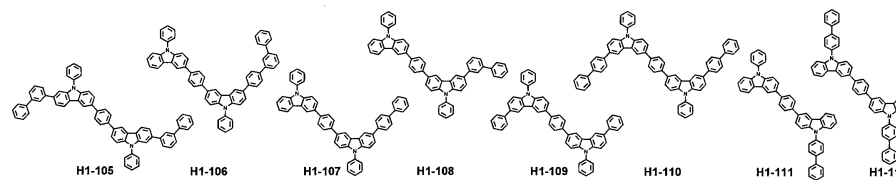
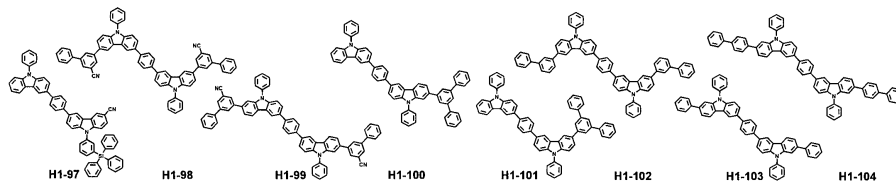
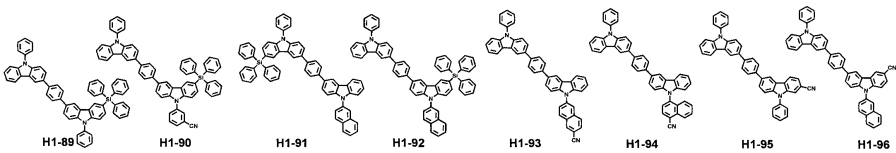
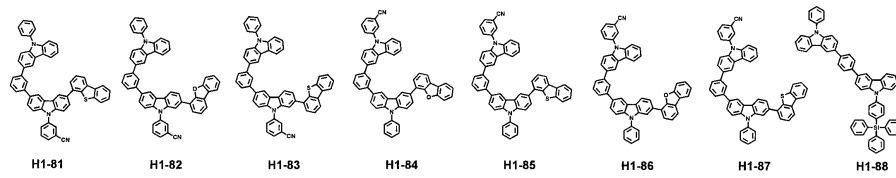
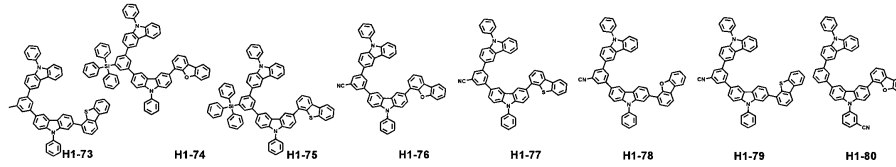
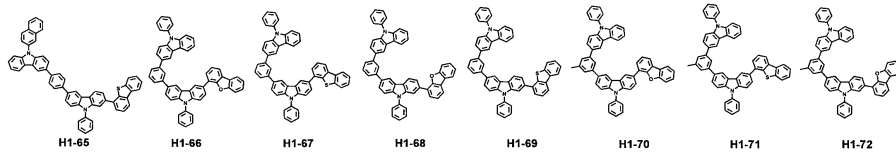
청구항 7

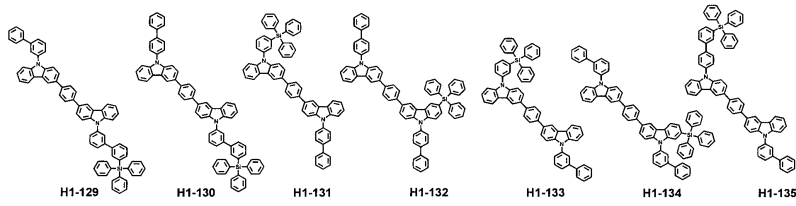
제1항에 있어서, 상기 화학식 1에서 X_1 내지 X_{16} 으로서의 트리아릴실릴은 트리페닐실릴인, 유기 전계 발광 소자.

청구항 8

제1항에 있어서, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 하기 화합물로부터 선택되는 것인, 유기 전계 발광 소자.

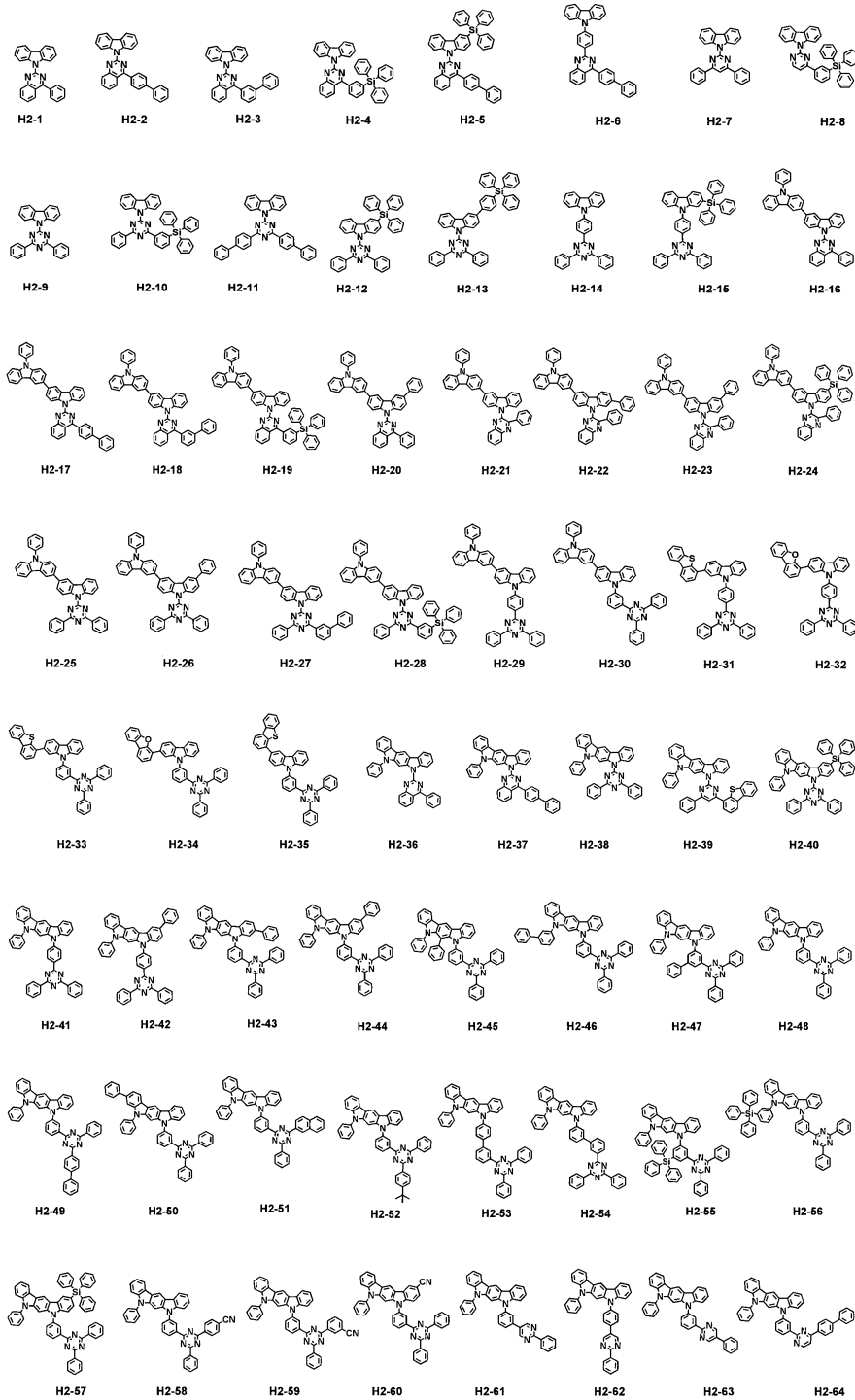


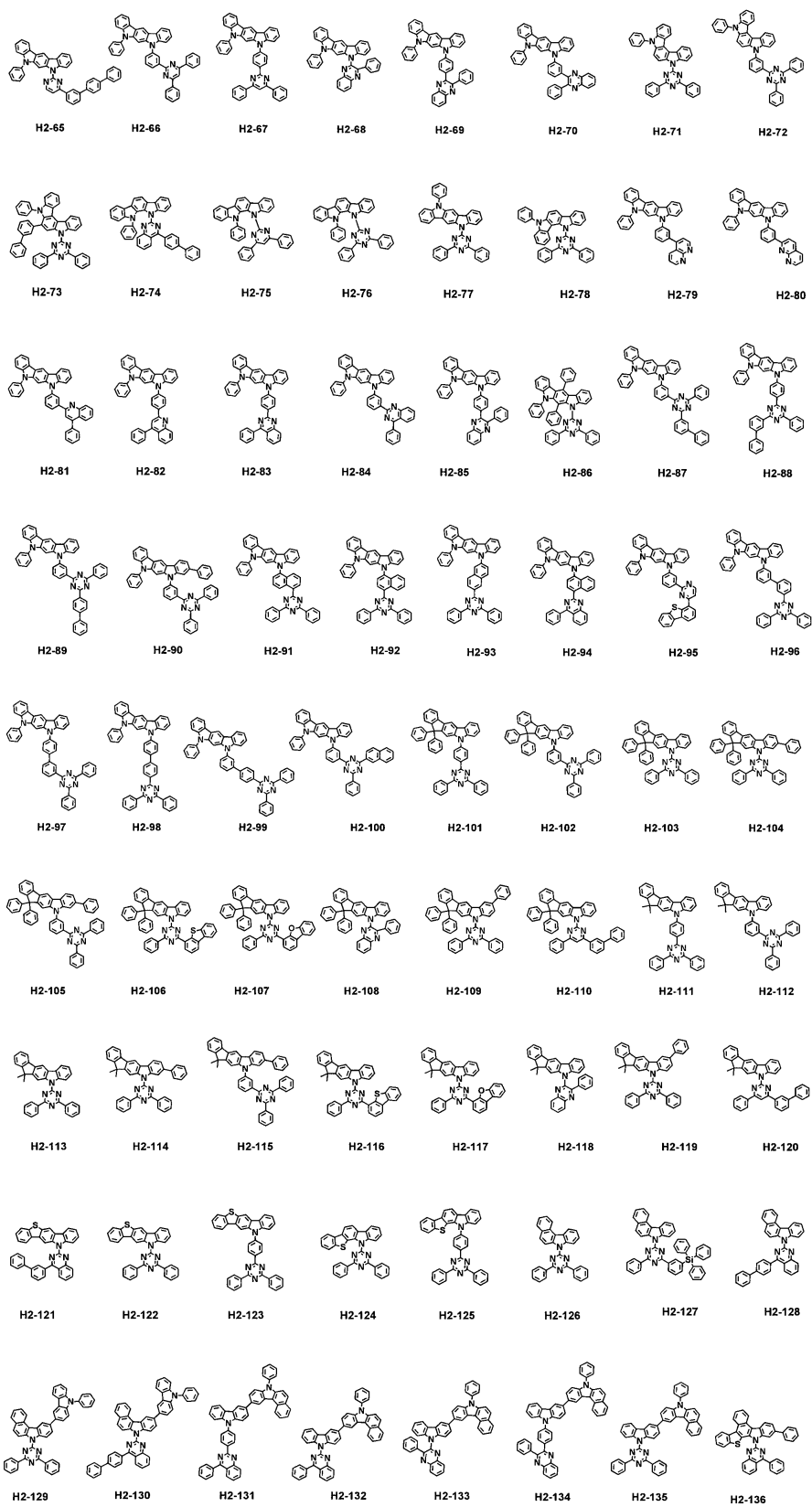


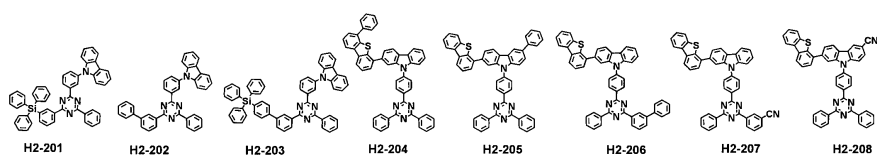
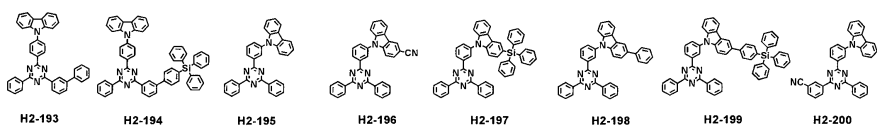
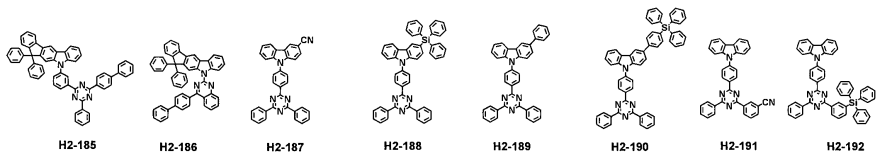
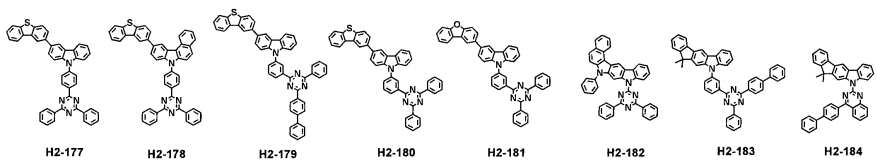
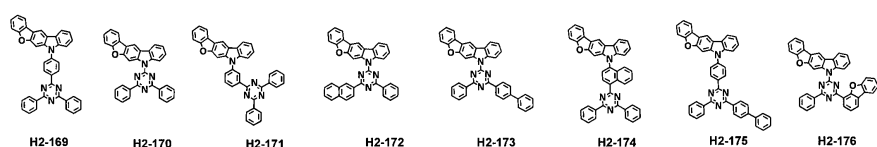
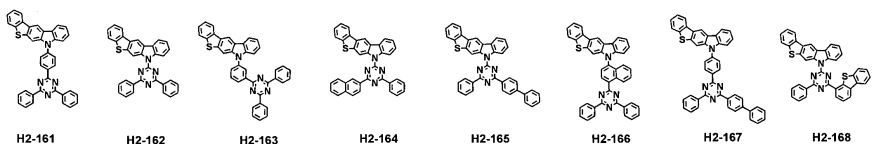
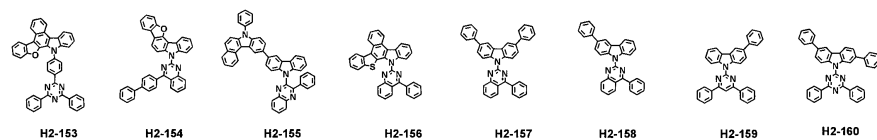
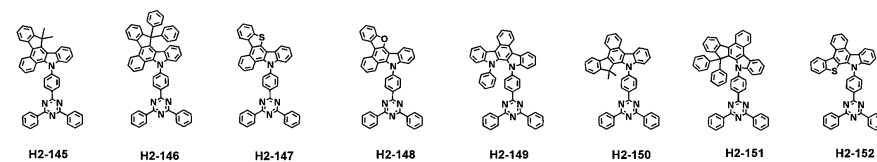
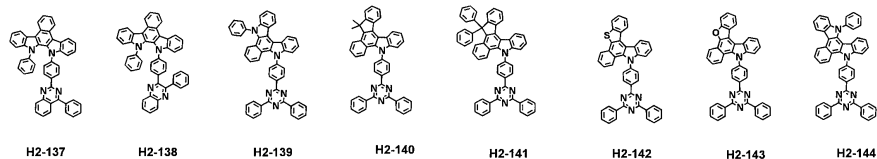


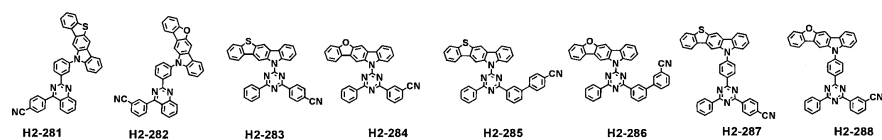
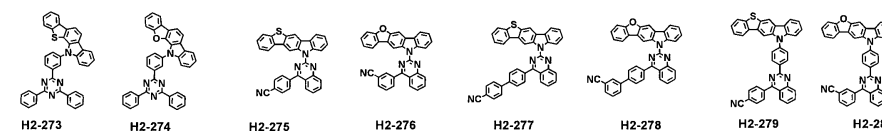
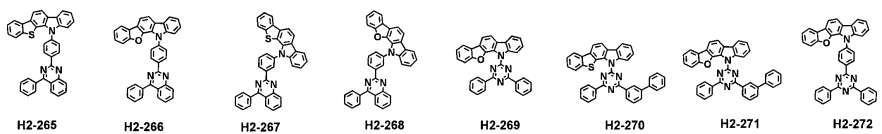
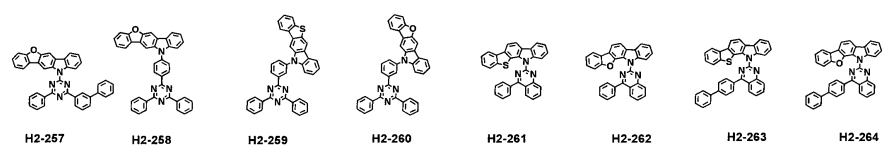
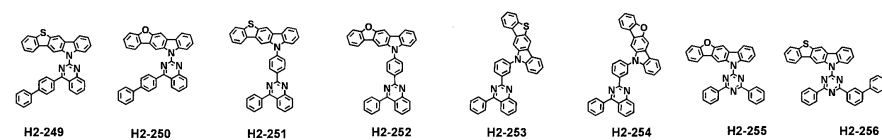
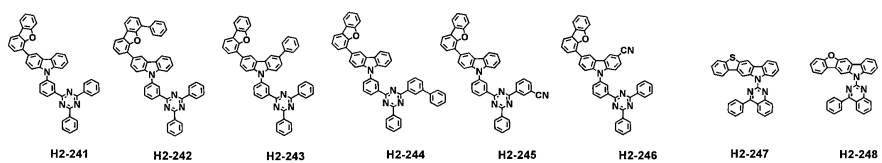
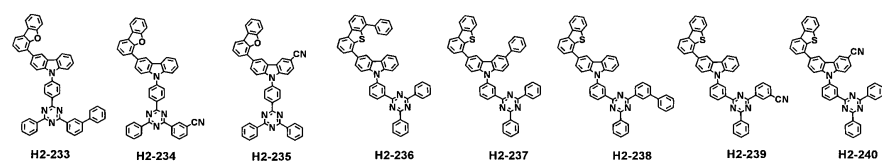
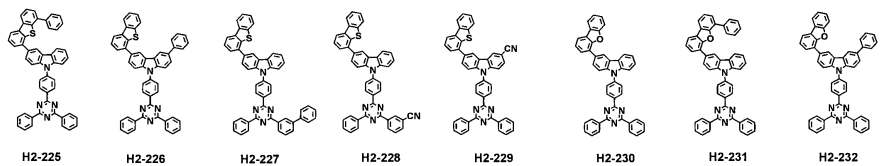
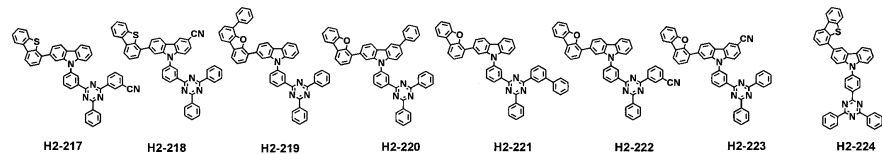
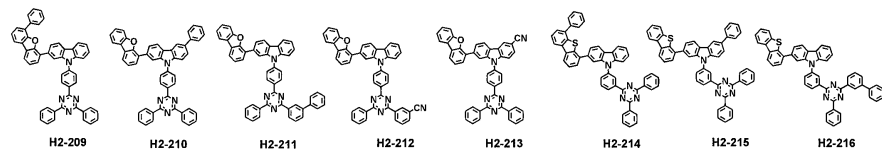
청구항 9

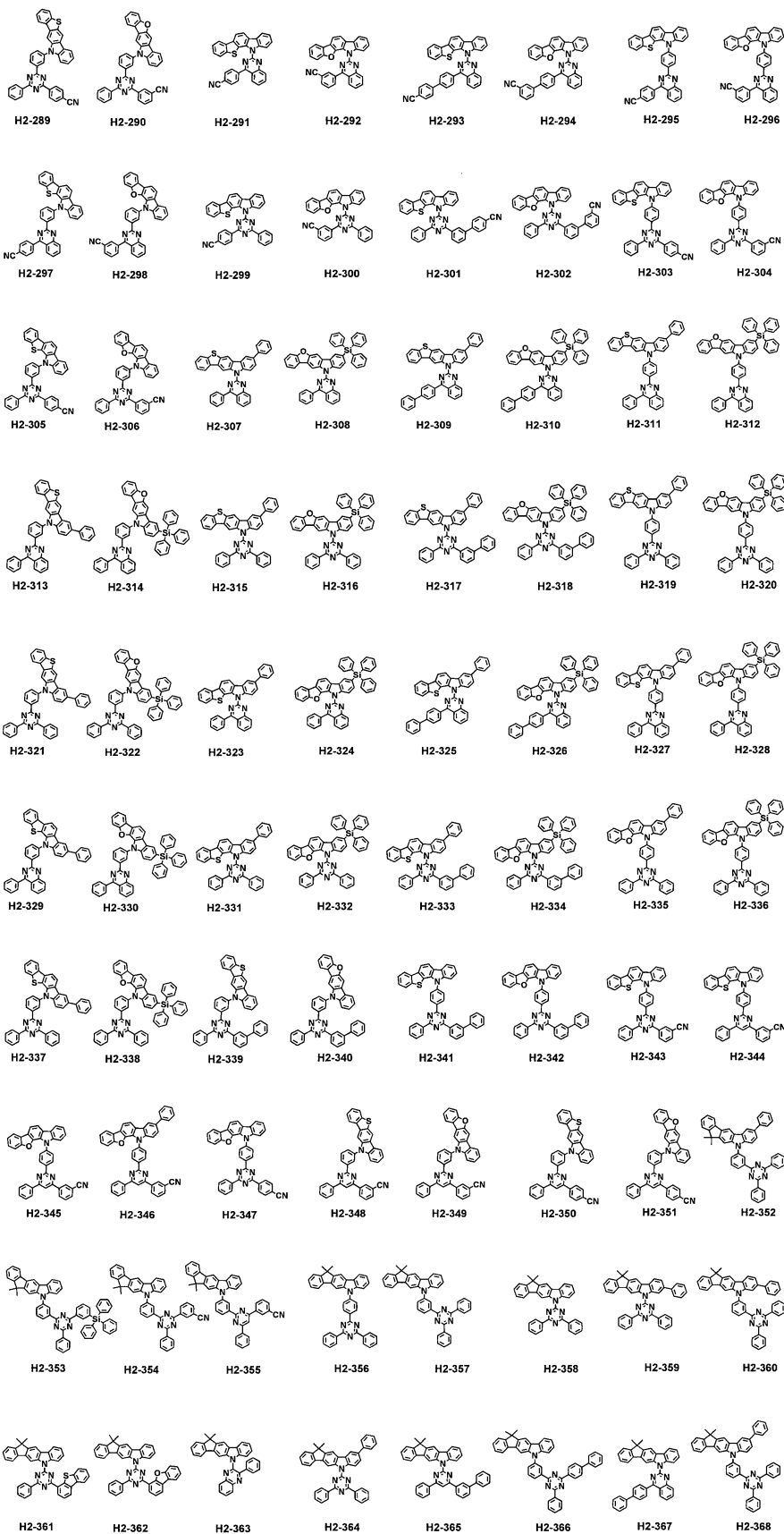
제1항에 있어서, 상기 화학식 2로 표시되는 화합물은 하기 화합물로부터 선택되는 것인, 유기 전계 발광 소자.

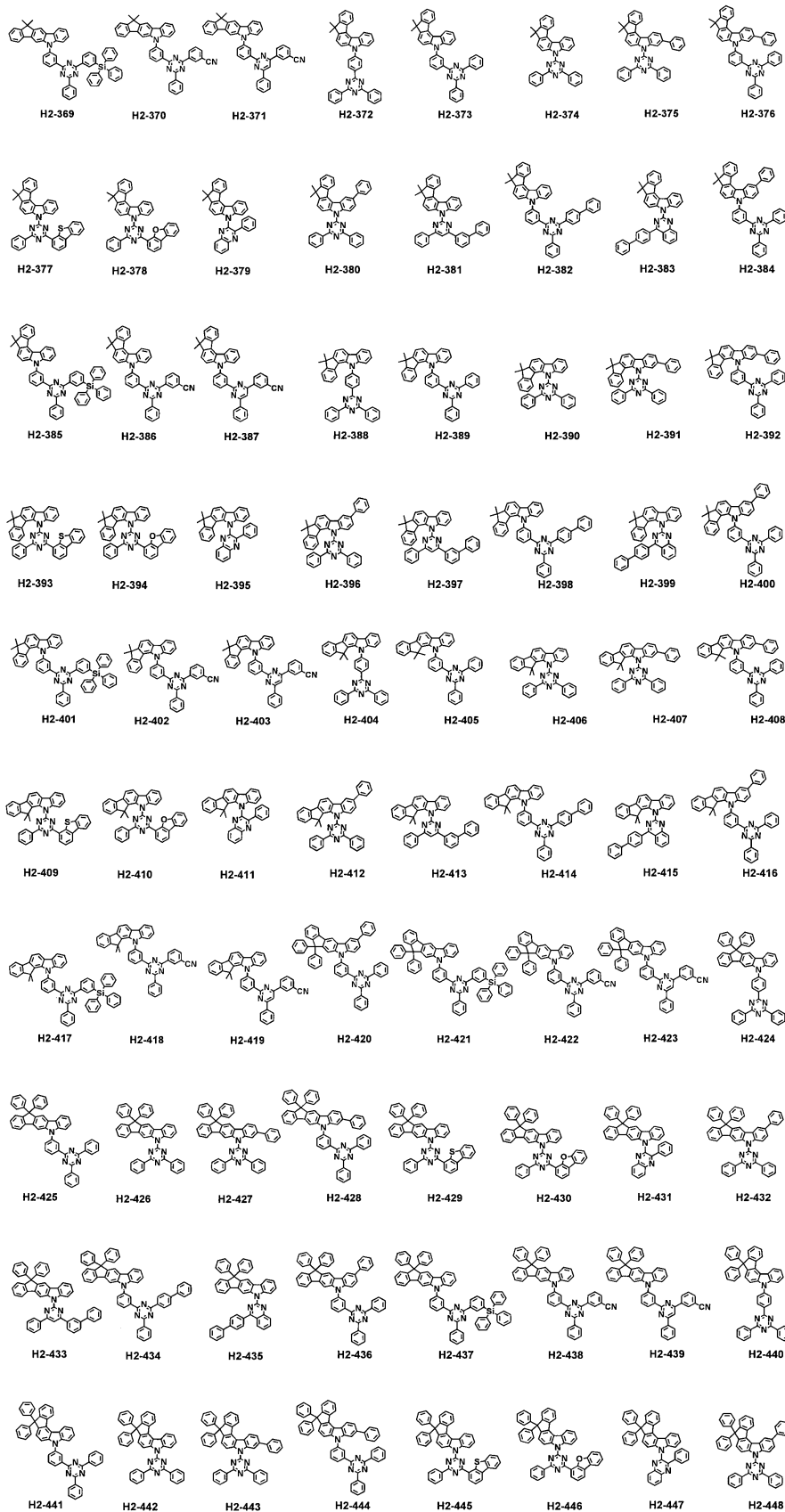


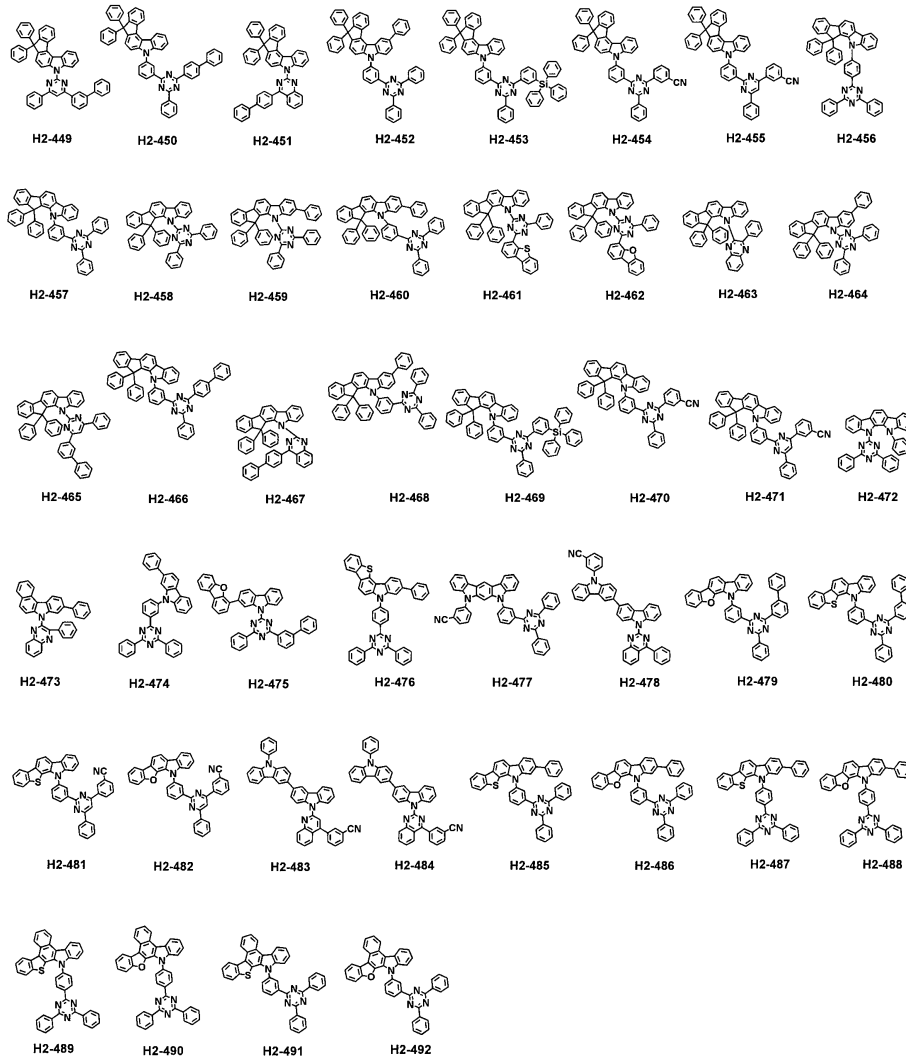












명세서

기술분야

[0001] 본 발명은 복수종의 호스트 재료 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자에 관한 것이다.

배경기술

[0002] 전계 발광 소자(electroluminescence device: EL device)는 자체 발광형 표시 소자로서 시야각이 넓고 콘트라스트가 우수할 뿐만 아니라 응답속도가 빠르다는 장점을 가지고 있다. 1987년 이스트만 코닥(Eastman Kodak)사는 발광층 형성용 재료로서 저분자인 방향족 디아민과 알루미늄 착물을 이용하고 있는 유기 전계 발광 소자를 처음으로 개발하였다[Appl. Phys. Lett. 51, 913, 1987].

[0003] 유기 전계 발광 소자(organic electroluminescence device: OLED)는 유기 발광 재료에 전기를 가해 전기 에너지를 빛으로 바꾸는 소자로서, 통상 양극 및 음극과 이들 사이에 유기물층을 포함하는 구조를 가진다. 유기 전계 발광 소자의 유기물층은 정공주입층, 정공전달층, 전자차단층, 발광층(호스트 및 도판트 재료 포함), 전자버퍼층, 정공차단층, 전자전달층, 전자주입층 등으로 이루어질 수 있으며, 유기물층에 사용되는 재료는 기능에 따라 정공주입 재료, 정공전달 재료, 전자차단 재료, 발광 재료, 전자버퍼 재료, 정공차단 재료, 전자전달 재료, 전자주입 재료 등으로 나뉜다. 이러한 유기 전계 발광 소자에서는 전압 인가에 의해 양극에서 정공이, 음극에서 전자가 발광층에 주입되고, 정공과 전자의 재결합에 의해 에너지가 높은 엑시톤이 형성된다. 이 에너지에 의해 발광 유기 화합물이 여기 상태로 되며, 발광 유기 화합물의 여기 상태가 기저 상태로 돌아가면서 에너지를 빛으로 방출하여 발광하게 된다.

[0004] 유기 전계 발광 소자의 발광 재료는 소자의 발광 효율을 결정하는 가장 중요한 요인으로서, 발광 재료는 양자 효율이 높고 전자와 정공의 이동도가 커야 하고, 형성된 발광 재료층은 균일하고 안정해야 한다. 이러한 발광 재료는 발광색에 따라 청색, 녹색 또는 적색 발광 재료로 나뉘고, 추가로 황색 또는 주황색 발광 재료도 있다. 또한, 발광 재료는 기능적인 측면에서 호스트 재료와 도판트 재료로 구분될 수 있다. 최근에 고효율 및 장수명의 유기 전계 발광 소자의 개발이 시급한 과제로 대두되고 있는데, 특히 중대형 OLED 패널에서 요구하고 있는 EL 특성 수준을 고려해 볼 때 기존의 발광 재료에 비해 매우 우수한 재료의 개발이 시급한 실정이다. 이를 위하여 고체 상태의 용매 및 에너지 전달자 역할을 하는 호스트 물질의 바람직한 특성은 순도가 높아야 하며, 진공 증착이 가능하도록 적당한 분자량을 가져야 한다. 또한 유리 전이온도와 열분해온도가 높아 열적 안정성을 확보해야 하며, 장수명화를 위해 높은 전기화학적 안정성이 요구되며, 부정형 박막을 형성하기 용이해야 하며, 인접한 다른 층의 재료들과는 접착력이 좋은 반면 층간 이동은 하지 않아야 한다.

[0005] 발광 재료는 색순도, 발광 효율 및 안정성을 향상시키기 위해 호스트와 도판트를 혼합하여 사용할 수 있다. 일반적으로, EL 특성이 우수한 소자는 호스트에 도판트를 도핑하여 만들어진 발광층을 포함하는 구조이다. 이와 같은 도판트/호스트 재료 체계를 사용할 때, 호스트 재료는 발광 소자의 효율과 수명에 큰 영향을 미치므로, 그 선택이 중요하다.

[0006] 국제 공개공보 WO 2013/168688 A1, WO 2009/060757 A1 및 일본 특허공개공보 JP 2013-183036 A1 등은 비스카바졸 유도체를 호스트 재료로 사용한 유기 전계 발광 소자를 개시하고 있다. 그러나, 상기 문헌들은 아릴을 포함하는 비스카바졸 유도체 및 질소 함유 헤테로아릴을 포함하는 카바졸 유도체를 복수종의 호스트로 사용한 유기 전계 발광 소자에 대하여는 구체적으로 개시하고 있지 않다.

선행기술문헌

특허문헌

- [0007] (특허문헌 0001) 국제 공개공보 WO 2013/168688 A1 (2013. 11. 14 발행)
- (특허문헌 0002) 국제 공개공보 WO 2009/060757 A1 (2009. 5. 14 발행)
- (특허문헌 0003) 일본 특허공개공보 JP 2013-183036 A1 (2013. 9. 12 발행)

발명의 내용

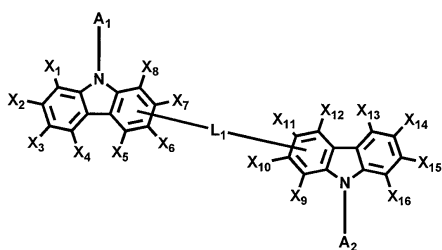
해결하려는 과제

[0008] 본 발명의 목적은 고효율과 장수명을 갖는 유기 전계 발광 소자를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0009] 상기의 기술적 과제를 해결하기 위해 예의 연구한 결과, 본 발명자들은 양극과 음극 사이에 적어도 1층의 발광층을 갖고, 상기 발광층에는 호스트와 인광 도판트를 포함하고, 상기 호스트는 복수종의 호스트 화합물로 구성되고, 상기 복수종의 호스트 화합물 중 적어도 제1 호스트 화합물은 화학식 1로 표시되고, 제2 호스트 화합물은 화학식 2로 표시되는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 소자가 상술한 목적을 달성함을 발견하여 본 발명을 완성하였다.

[0010] [화학식 1]

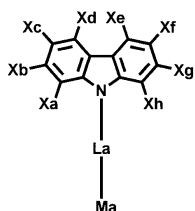


[0011]

- [0012] 상기 화학식 1에서,
- [0013] A₁ 및 A₂는 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아릴이고;
- [0014] L₁은 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아릴렌이고;

[0015] X₁ 내지 X₁₆은 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 시아노, 치환 또는 비치환된 (C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된 (C2-C30)알케닐, 치환 또는 비치환된 (C2-C30)알키닐, 치환 또는 비치환된 (C3-C30)시클로알킬, 치환 또는 비치환된 (C6-C60)아릴, 치환 또는 비치환된 (3-30원)헤테로아릴, 치환 또는 비치환된 트리(C1-C30)알킬실릴, 치환 또는 비치환된 트리(C6-C30)아릴실릴, 치환 또는 비치환된 디(C1-C30)알킬(C6-C30)아릴실릴, 또는 치환 또는 비치환된 모노- 또는 디- (C6-C30)아릴아미노이거나; 인접한 치환기끼리 서로 연결되어 치환 또는 비치환된 (C3-C30) 단일환 또는 다환의 지환족 또는 방향족 고리를 형성할 수 있으며, 상기 형성된 지환족 또는 방향족 고리의 탄소 원자는 질소, 산소 및 황으로부터 선택되는 하나 이상의 헤테로원자로 대체될 수 있고;

[0016] [화학식 2]



- [0017]
- [0018] 상기 화학식 2에서,
- [0019] Ma는 치환 또는 비치환된 질소 함유 (5-11원)헤테로아릴이고;
- [0020] La는 단일 결합, 또는 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아릴렌이고;

[0021] X_a 내지 X_h는 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 시아노, 치환 또는 비치환된 (C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된 (C2-C30)알케닐, 치환 또는 비치환된 (C2-C30)알키닐, 치환 또는 비치환된 (C3-C30)시클로알킬, 치환 또는 비치환된 (C6-C60)아릴, 치환 또는 비치환된 (3-30원)헤테로아릴, 치환 또는 비치환된 트리(C1-C30)알킬실릴, 치환 또는 비치환된 트리(C6-C30)아릴실릴, 치환 또는 비치환된 디(C1-C30)알킬(C6-C30)아릴실릴, 또는 치환 또는 비치환된 모노- 또는 디- (C6-C30)아릴아미노이거나; 인접한 치환기끼리 서로 연결되어 치환 또는 비치환된 (C3-C30)단일환 또는 다환의 지환족 또는 방향족 고리를 형성할 수 있으며, 상기 형성된 지환족 또는 방향족 고리의 탄소 원자는 질소, 산소 및 황으로부터 선택되는 하나 이상의 헤테로원자로 대체될 수 있고;

[0022] 상기 헤테로아릴은 B, N, O, S, P(=O), Si 및 P로부터 선택된 하나 이상의 헤테로원자를 포함한다.

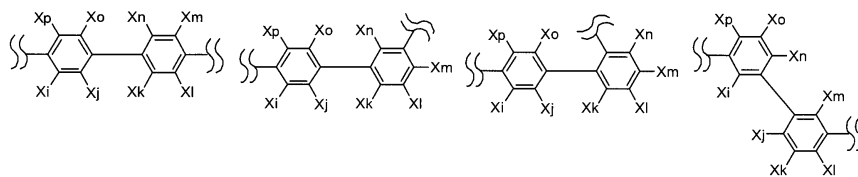
발명의 효과

[0023] 본 발명에 따르면 고효율 및 장수명을 갖는 유기 전계 발광 소자가 제공되며, 이를 이용한 표시 장치 또는 조명 장치의 제조가 가능하다.

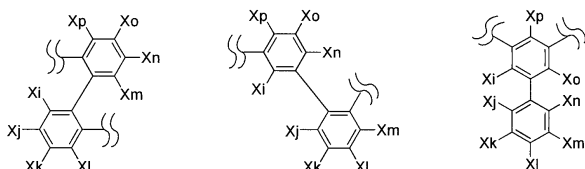
발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0024] 이하에서 본 발명을 더욱 상세히 설명하나, 이는 설명을 위한 것으로 본 발명의 범위를 제한하는 방법으로 해석되어서는 안 된다.
- [0025] 상기 화학식 1 및 2로 표시되는 유기 전계 발광 화합물을 포함하는 유기 전계 발광 소자에 대해 보다 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
- [0026] 상기 화학식 1의 화합물은 하기 화학식 3, 4, 5 또는 6으로 표시될 수 있다.

[0039] [화학식 13] [화학식 14] [화학식 15] [화학식 16]



[0040]
[0041] [화학식 17] [화학식 18] [화학식 19]



[0042]
[0043] 상기 화학식 7 내지 19에서,

[0044] Xi 내지 Xp는 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 시아노, 치환 또는 비치환된 (C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된 (C2-C30)알케닐, 치환 또는 비치환된 (C2-C30)알키닐, 치환 또는 비치환된 (C3-C30)시클로알킬, 치환 또는 비치환된 (C6-C60)아릴, 치환 또는 비치환된 (3-30원)헤테로아릴, 치환 또는 비치환된 트리(C1-C30)알킬실릴, 치환 또는 비치환된 트리(C6-C30)아릴실릴, 치환 또는 비치환된 디(C1-C30)알킬(C6-C30)아릴실릴, 또는 치환 또는 비치환된 모노- 또는 디- (C6-C30)아릴아미노이거나; 인접한 치환기끼리 서로 연결되어 치환 또는 비치환된 (C3-C30) 단일환 또는 다환의 지환족 또는 방향족 고리를 형성할 수 있으며, 상기 형성된 지환족 또는 방향족 고리의 탄소 원자는 질소, 산소, 및 황으로부터 선택되는 하나 이상의 헤테로원자로 대체될 수 있다.

[0045] 상기 화학식 2에서, Ma는 치환 또는 비치환된 질소 함유 (5-11원)헤테로아릴이고, 치환 또는 비치환된 질소 함유 (6-10원)헤테로아릴인 것이 바람직하고, 비치환된 (C6-C18)아릴, 시아노로 치환된 (C6-C12)아릴, (C1-C6)알킬로 치환된 (C6-C12)아릴, 트리(C6-C12)아릴실릴로 치환된 (C6-C12)아릴, 또는 (6-15원)헤테로아릴로 치환된 질소 함유 (6-10원)헤테로아릴인 것이 더욱 바람직하다.

[0046] 또한, Ma는 피롤릴, 이미다졸릴, 피라졸릴, 트리아진일, 테트라진일, 트리아졸릴, 테트라졸릴, 피리딜, 피라진일, 피리미딘일, 피리다진일 등의 단일 환계 헤테로아릴이거나, 벤조이미다졸릴, 이소인돌릴, 인돌릴, 인다졸릴, 벤조티아디아졸릴, 퀴놀릴, 이소퀴놀릴, 신놀리닐, 퀴나졸리닐, 나프티리디닐, 또는 퀴녹살리닐 등의 융합 환계 헤테로아릴일 수 있고, 바람직하게는 트리아진일, 피리미딘일, 피리딜, 퀴놀릴, 이소퀴놀릴, 퀴나졸리닐, 나프티리디닐, 또는 퀴녹살리닐이다.

[0047] 상기 화학식 2에서, La는 단일 결합, 또는 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아릴렌이고, 단일 결합 또는 치환 또는 비치환된 (C6-C12)아릴렌인 것이 바람직하고, 단일 결합 또는 트리(C6-C10)아릴실릴로 치환 또는 비치환된 (C6-C12)아릴렌인 것이 더욱 바람직하다.

[0048] 또한, La는 단일 결합이거나, 상기 화학식 7 내지 19 중 하나로 표시될 수 있다.

[0049] 상기 화학식 2에서, Xa 내지 Xh는 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 시아노, 치환 또는 비치환된 (C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된 (C2-C30)알케닐, 치환 또는 비치환된 (C2-C30)알키닐, 치환 또는 비치환된 (C3-C30)시클로알킬, 치환 또는 비치환된 (C6-C60)아릴, 치환 또는 비치환된 (3-30원)헤테로아릴, 치환 또는 비치환된 트리(C1-C30)알킬실릴, 치환 또는 비치환된 트리(C6-C30)아릴실릴, 치환 또는 비치환된 디(C1-C30)알킬(C6-C30)아릴실릴, 또는 치환 또는 비치환된 모노- 또는 디- (C6-C30)아릴아미노이거나; 인접한 치환기끼리 서로 연결되어 치환 또는 비치환된 (C3-C30)단일환 또는 다환의 지환족 또는 방향족 고리를 형성할 수 있으며, 상기 형성된 지환족 또는 방향족 고리의 탄소 원자는 질소, 산소 및 황으로부터 선택되는 하나 이상의 헤테로원자로 대체될 수 있고, 각각 독립적으로 수소, 시아노, 치환 또는 비치환된 (C6-C15)아릴, 치환 또는 비치환된 (10-20원)헤테로아릴, 또는 치환 또는 비치환된 트리(C6-C10)아릴실릴이거나; 인접한 치환기끼리 서로 연결되어 치환 또는 비치환된 (C6-C20)단일환 또는 다환의 방향족 고리를 형성하는 것이 바람직하고, 각각 독립적으로 수소; 시아노; 트리(C6-C10)아릴실릴로 치환 또는 비치환된 (C6-C15)아릴; (C6-C12)아릴 또는 시아노(C6-C12)아릴

로 치환 또는 비치환된 (10-20원)헤테로아릴; 또는 비치환된 트리(C6-C10)아릴실릴이거나; 인접한 치환기끼리 서로 연결되어 치환 또는 비치환된 벤젠, 치환 또는 비치환된 인돌, 치환 또는 비치환된 벤조인돌, 치환 또는 비치환된 인덴, 치환 또는 비치환된 벤조푸란, 또는 치환 또는 비치환된 벤조티오펜을 형성하는 것이 더욱 바람직하다.

[0050]

본 발명에 기재되어 있는 "(C1-C30)알킬"은 탄소수가 1 내지 30개인 직쇄 또는 분지쇄 알킬을 의미하고, 여기에서 탄소수가 1 내지 20개인 것이 바람직하고, 1 내지 10개인 것이 더 바람직하다. 상기 알킬의 구체적인 예로서, 메틸, 에틸, n-프로필, 이소프로필, n-부틸, 이소부틸 및 3급-부틸 등이 있다. 본원에서 "(C2-C30)알킬"은 탄소수가 2 내지 30개인 직쇄 또는 분지쇄 알케닐을 의미하고, 여기에서 탄소수가 2 내지 20개인 것이 바람직하고, 2 내지 10개인 것이 더 바람직하다. 상기 알케닐의 구체적인 예로서, 비닐, 1-프로페닐, 2-프로페닐, 1-부테닐, 2-부테닐, 3-부테닐, 2-메틸부트-2-에닐 등이 있다. 본원에서 "(C2-C30)알킬"은 탄소수가 2 내지 30개인 직쇄 또는 분지쇄 알킬을 의미하고, 여기에서 탄소수가 2 내지 20개인 것이 바람직하고, 2 내지 10개인 것이 더 바람직하다. 상기 알킬의 예로서, 에틸, 1-프로피닐, 2-프로피닐, 1-부티닐, 2-부티닐, 3-부티닐, 1-메틸헥트-2-에닐 등이 있다. 본원에서 "(C3-C30)시클로알킬"은 탄소수가 3 내지 30개인 단일환 또는 다환 탄화수소를 의미하고, 여기에서 탄소수가 3 내지 20개인 것이 바람직하고, 3 내지 7개인 것이 더 바람직하다. 상기 시클로알킬의 예로서, 시클로프로필, 시클로부틸, 시클로펜틸, 시클로헥실 등이 있다. 본원에서 "(3-7원)헤테로시클로알킬"은 환 골격 원자수가 3 내지 7개, 바람직하게는 5 내지 7개이고, B, N, O, S, P(=O), Si 및 P로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상의 헤테로원자, 바람직하게는 O, S 및 N에서 선택되는 하나 이상의 헤테로원자를 포함하는 시클로알킬을 의미하고, 예를 들어, 테트라히드로푸란, 피롤리딘, 티올란, 테트라히드로피란 등이 있다. 본원에서 "(C6-C30)아릴(렌)"은 탄소수가 6 내지 30개인 방향족 탄화수소에서 유래된 단일환 또는 융합환계 라디칼을 의미하고, 여기에서 환 골격 탄소수가 6 내지 20개인 것이 바람직하고, 6 내지 15개인 것이 더 바람직하다. 상기 아릴의 예로서, 페닐, 비페닐, 터페닐, 나프틸, 비나프틸, 페닐나프틸, 나프틸페닐, 플루오레닐, 페닐플루오레닐, 벤조플루오레닐, 디벤조플루오레닐, 페난트레닐, 페닐페난트레닐, 안트라세닐, 인데닐, 트리페닐레닐, 피레닐, 테트라세닐, 페틸레닐, 크라이세닐, 나프타세닐, 플루오란테닐 등이 있다. 본원에서 "(3-30원)헤테로아릴"은 환 골격 원자수가 3 내지 30개이고, B, N, O, S, P(=O), Si 및 P로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상의 헤테로원자를 포함하는 아릴기를 의미한다. 헤테로원자수는 바람직하게는 1 내지 4개이고, 단일 환계이거나 하나 이상의 벤젠환과 축합된 융합환계일 수 있으며, 부분적으로 포화될 수도 있다. 또한, 본원에서 상기 헤테로아릴은 하나 이상의 헤테로아릴기 또는 아릴기가 단일 결합에 의해 헤테로아릴기와 연결된 형태도 포함한다. 상기 헤테로아릴의 예로서, 푸릴, 티오펜일, 피롤릴, 이미다졸릴, 피라졸릴, 티아졸릴, 티아디아졸릴, 이소티아졸릴, 이속사졸릴, 옥사졸릴, 옥사디아졸릴, 트리아진일, 테트라진일, 트리아졸릴, 테트라졸릴, 푸라잔일, 피리딜, 피라진일, 피리미딘일, 피리다진일 등의 단일 환계 헤테로아릴, 벤조푸란일, 벤조티오펜일, 이소벤조푸란일, 디벤조푸란일, 디벤조티오펜일, 벤조이미다졸릴, 벤조티아졸릴, 벤조이소티아졸릴, 벤조이속사졸릴, 벤조옥사졸릴, 이소인돌릴, 인돌릴, 벤조인돌릴, 인다졸릴, 벤조티아디아졸릴, 퀴놀릴, 이소퀴놀릴, 신놀리닐, 퀴나졸리닐, 퀴녹살리닐, 카바졸릴, 페녹사진일, 페난트리딘일, 벤조디옥솔릴 등의 융합 환계 헤테로아릴 등이 있다. 본원에서 "질소 함유 (5-30원)헤테로아릴"은 환 골격 원자수가 5 내지 30개이고 하나 이상의 헤테로원자 N을 포함하는 아릴기를 의미한다. 여기에서 환 골격 원자수가 5 내지 20개인 것이 바람직하고, 5 내지 15개인 것이 더 바람직하다. 헤테로원자수는 바람직하게는 1 내지 4개이고, 단일환계이거나 하나 이상의 벤젠환과 축합된 융합환계일 수 있으며, 부분적으로 포화될 수도 있다. 또한, 본원에서 상기 질소 함유 헤테로아릴은 하나 이상의 헤테로아릴기 또는 아릴기가 단일 결합에 의해 헤테로아릴기와 연결된 형태도 포함된다. 상기 질소 함유 헤테로아릴의 예로서, 피롤릴, 이미다졸릴, 피라졸릴, 트리아진일, 테트라진일, 트리아졸릴, 테트라졸릴, 피리딜, 피라진일, 피리미딘일, 피리다진일 등의 단일 환계 헤테로아릴, 벤조이미다졸릴, 이소인돌릴, 인돌릴, 인다졸릴, 벤조티아디아졸릴, 퀴놀릴, 이소퀴놀릴, 신놀리닐, 퀴나졸리닐, 퀴녹살리닐, 카바졸릴, 페난트리딘일 등의 융합 환계 헤테로아릴 등이 있다. 본원에서 "할로겐"은 F, Cl, Br 및 I 원자를 포함한다.

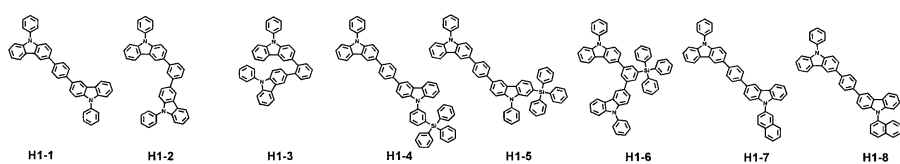
[0051]

또한 본 발명에 기재되어 있는 "치환 또는 비치환"이라는 기재에서 "치환"은 어떤 작용기에서 수소 원자가 다른 원자 또는 다른 작용기 (즉, 치환체)로 대체되는 것을 뜻한다. 상기 화학식 1 및 2의 상기 A₁, A₂, L₁, X₁ 내지 X₁₆, Ma, La 및 Xa 내지 Xh에서 치환 알킬, 치환 알케닐, 치환 알킬닐, 치환 시클로알킬, 치환 아릴(렌), 치환 헤테로아릴, 치환 트리알킬실릴, 치환 아릴실릴, 치환 디알킬아릴실릴, 치환 모노- 또는 디- 아릴아미노, 치환 질소 함유 헤테로아릴의 치환체는 각각 독립적으로 중수소, 할로겐, 시아노, 카르복실, 니트로, 히드록시, (C1-C30)알킬, 할로(C1-C30)알킬, (C2-C30)알케닐, (C2-C30)알킬닐, (C1-C30)알콕시, (C1-C30)알킬티오, (C3-C30)시클로알킬, (C3-C30)시클로알케닐, (3-7원)헤테로시클로알킬, (C6-C30)아릴옥시, (C6-C30)아릴티오, (C6-

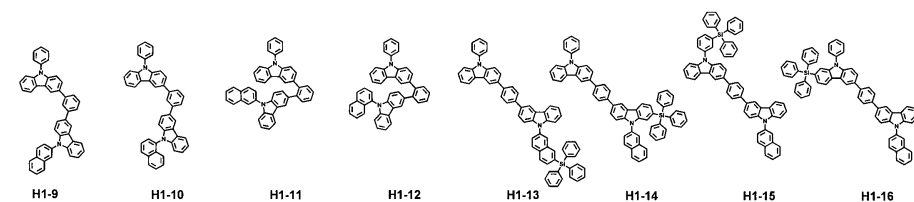
C30)아릴로 치환되거나 비치환된 (3-30원)헤테로아릴, 시아노, (3-30원)헤테로아릴 또는 트리(C6-C30)아릴실릴로 치환되거나 비치환된 (C6-C30)아릴, 트리(C1-C30)알킬실릴, 트리(C6-C30)아릴실릴, 디(C1-C30)알킬(C6-C30)아릴실릴, (C1-C30)알킬디(C6-C30)아릴실릴, 아미노, 모노- 또는 디- (C1-C30)알킬아미노, 모노- 또는 디-(C6-C30)아릴아미노, (C1-C30)알킬(C6-C30)아릴아미노, (C1-C30)알킬카보닐, (C1-C30)알콕시카보닐, (C6-C30)아릴카보닐, 디(C6-C30)아릴보로닐, 디(C1-C30)알킬보로닐, (C1-C30)알킬(C6-C30)아릴보로닐, (C6-C30)아르(C1-C30)알킬 및 (C1-C30)알킬(C6-C30)아릴로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상의 것을 의미하고, 각각 독립적으로 시아노, (C1-C6)알킬, (5-15원)헤테로아릴, 시아노, 또는 트리(C6-C12)아릴실릴로 치환되거나 비치환된 (C6-C18)아릴, 트리(C6-C12)아릴실릴 및 (C1-C6)알킬(C6-C12)아릴로 이루어진 군으로부터 선택되는 하나 이상인 것이 바람직하다.

[0052] 상기 화학식 1에서 X_1 내지 X_{16} 으로서의 트리아릴실릴은 바람직하게는 트리페닐실릴이다.

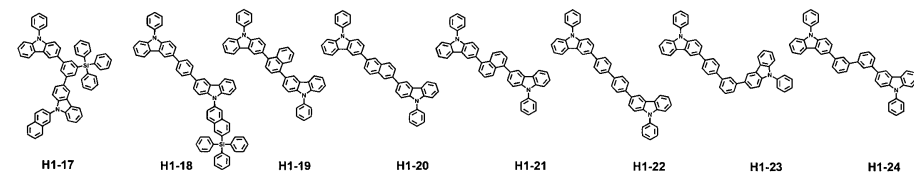
[0053] 상기 화학식 1로 표시되는 제1 호스트 화합물은 하기의 화합물로서 예시될 수 있으나, 이들에 한정되는 것은 아니다.



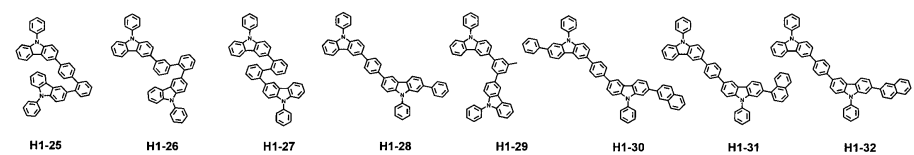
[0054]



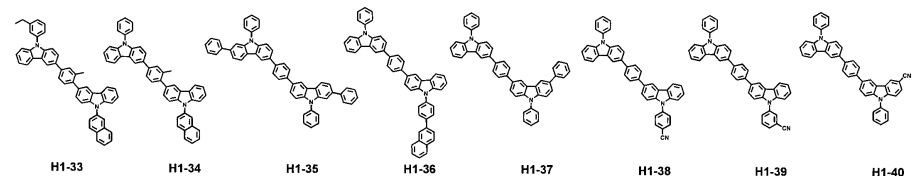
[0055]



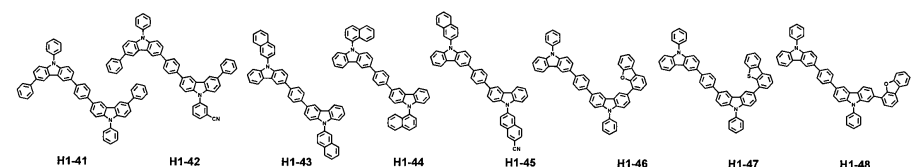
[0056]



[0057]

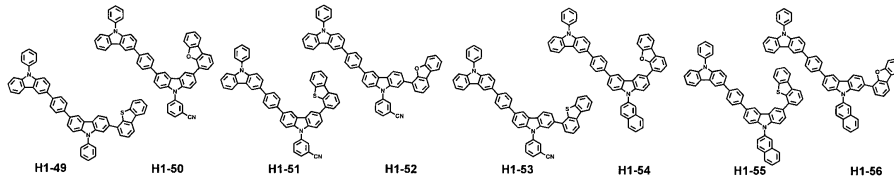


[0058]

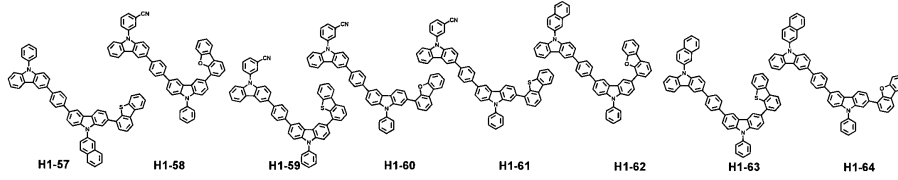


[0059]

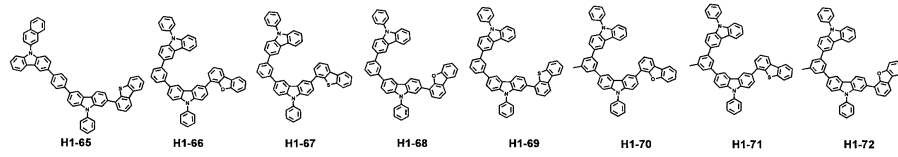
[0060]



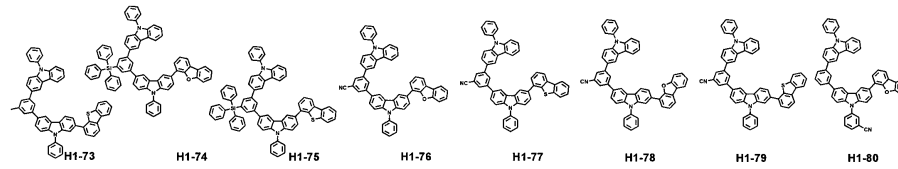
[0061]



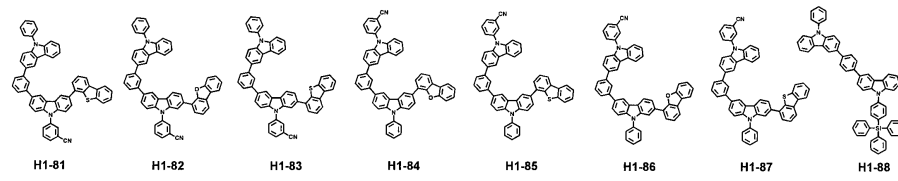
[0062]



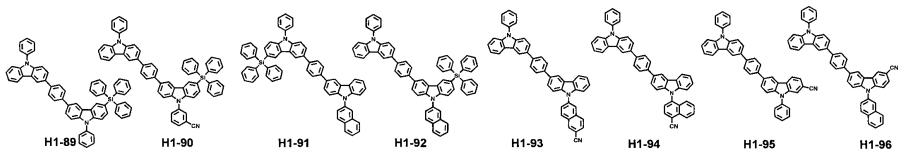
[0063]



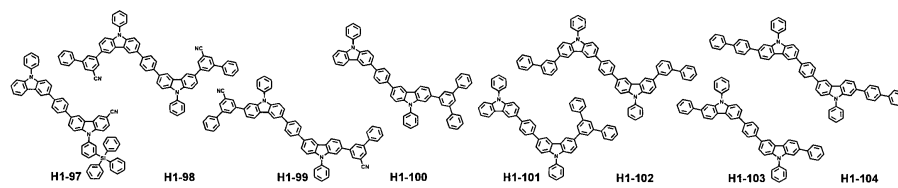
[0064]



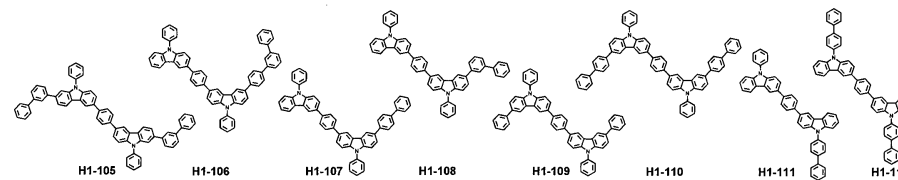
[0065]

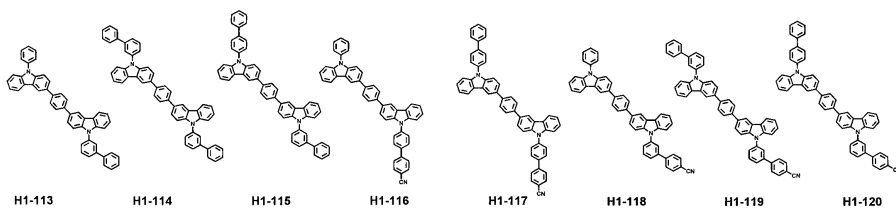


[0066]

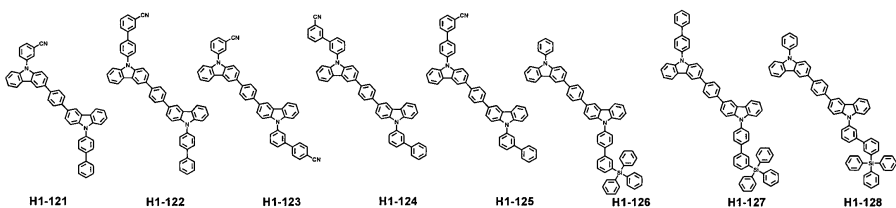


[0067]

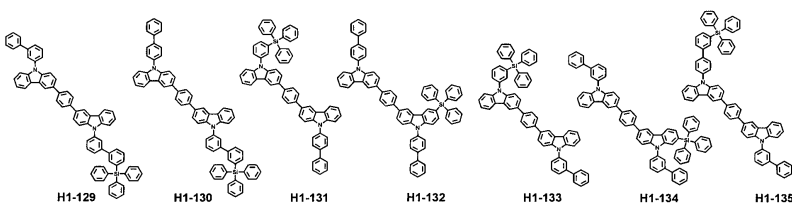




[0068]



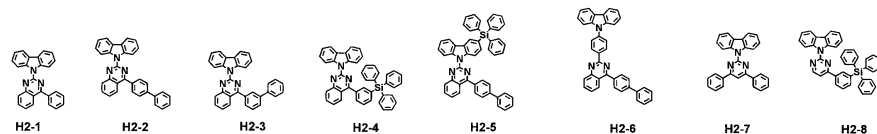
[0069]



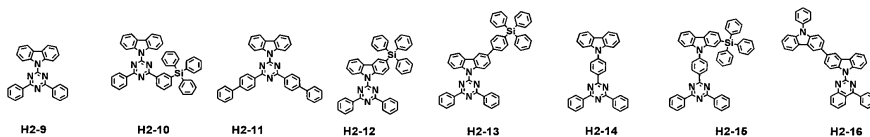
[0070]

[0071]

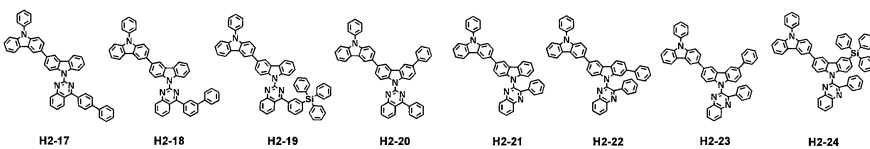
상기 화학식 2로 표시되는 제2 호스트 화합물은 하기의 화합물로서 예시될 수 있으나, 이들에 한정되는 것은 아니다.



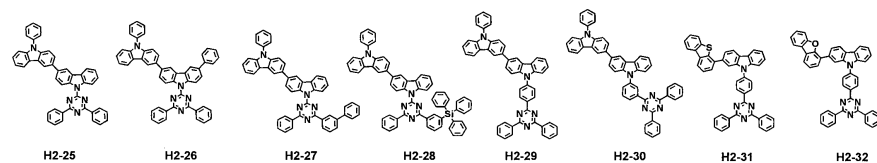
[0072]



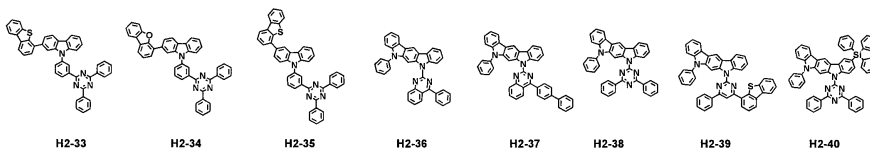
[0073]



[0074]

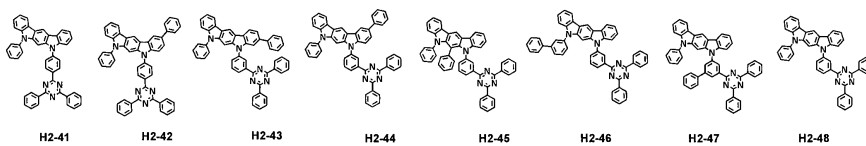


[0075]

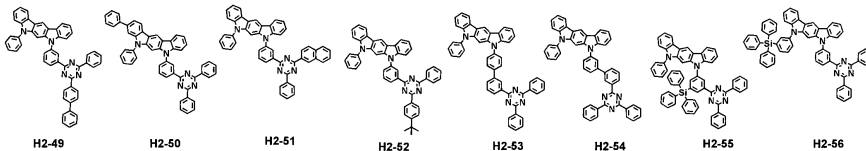


[0076]

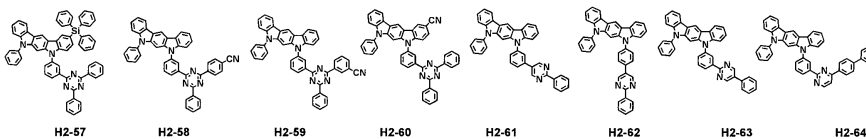
[0077]



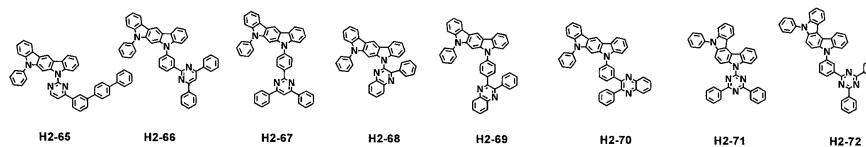
[0078]



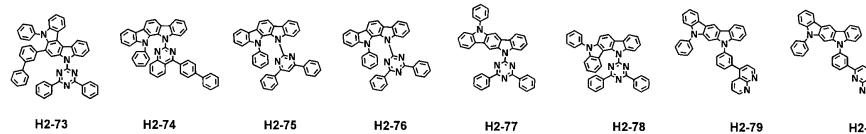
[0079]



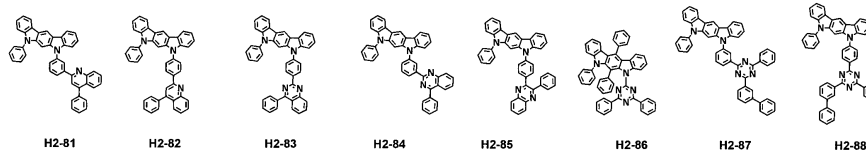
[0080]



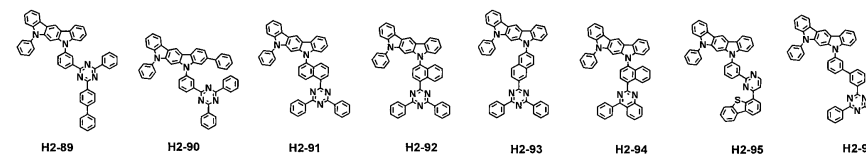
[0081]



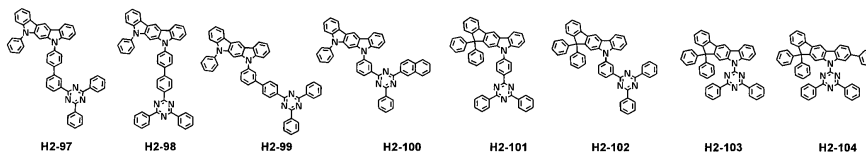
[0082]



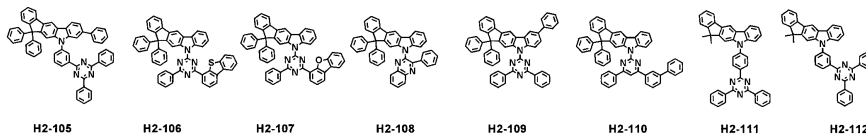
[0083]



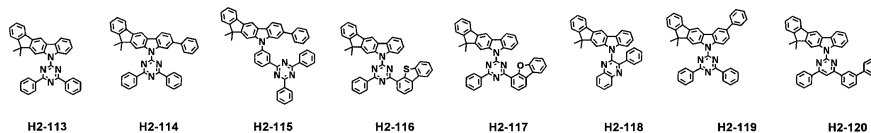
[0084]



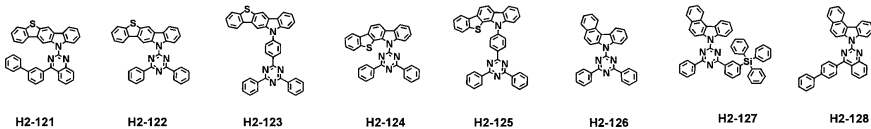
[0085]



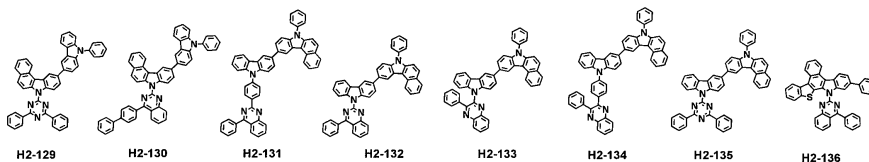
[0086]



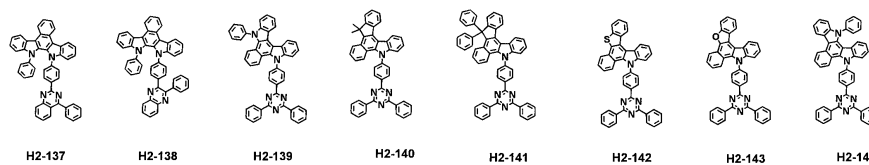
[0087]



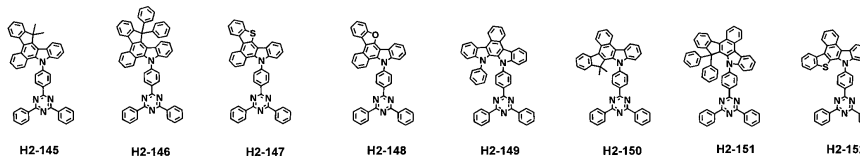
[0088]



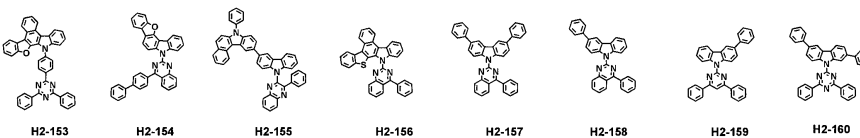
[0089]



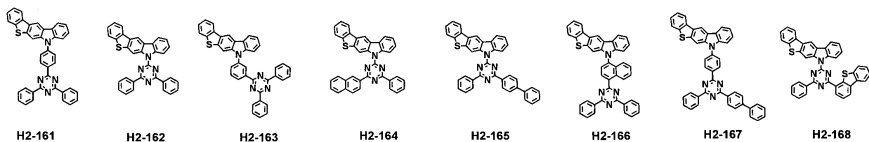
[0090]



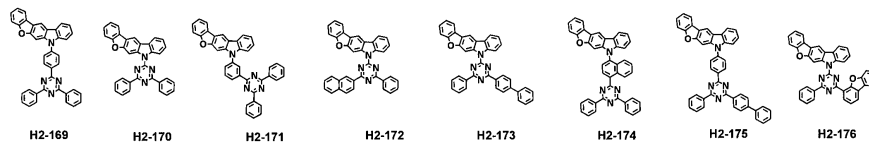
[0091]



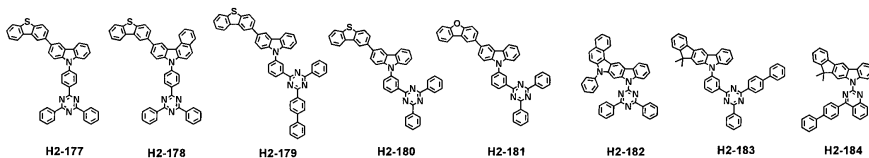
[0092]



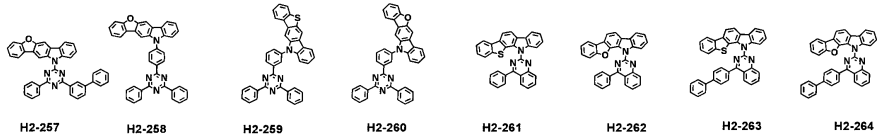
[0093]



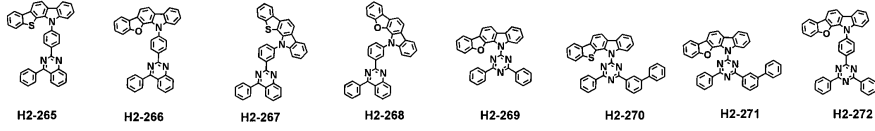
[0094]



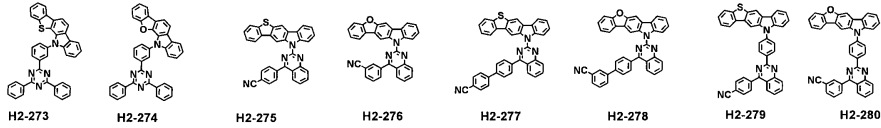
[0104]



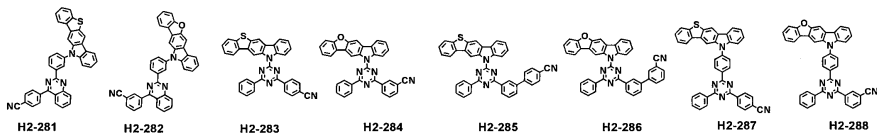
[0105]



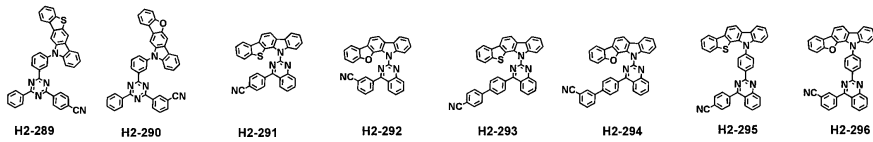
[0106]



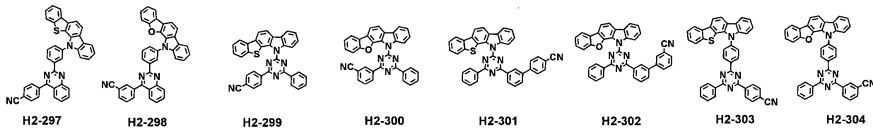
[0107]



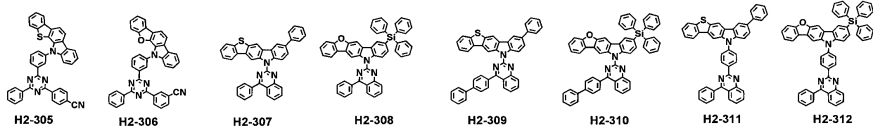
[0108]



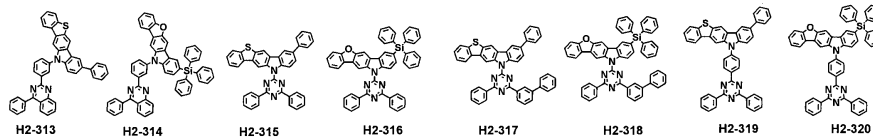
[0109]



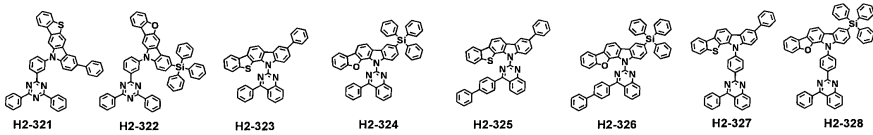
[0110]



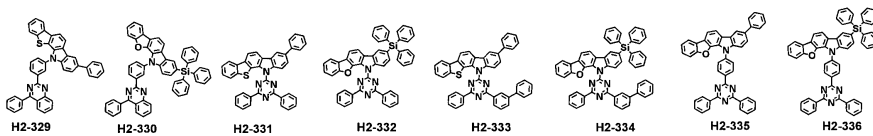
[0111]



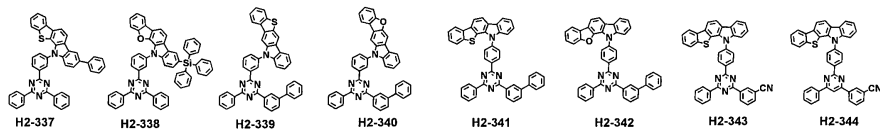
[0112]



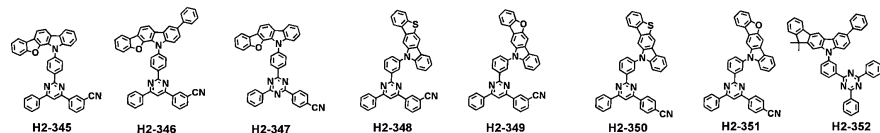
[0113]



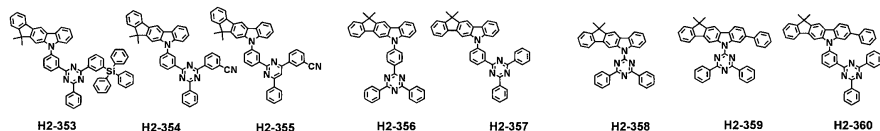
[0114]



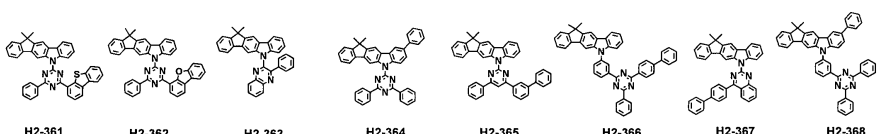
[0115]



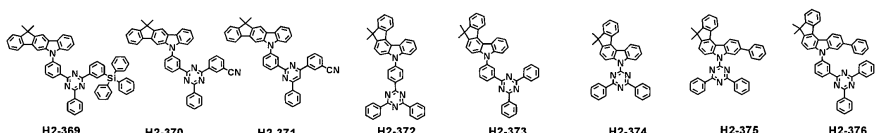
[0116]



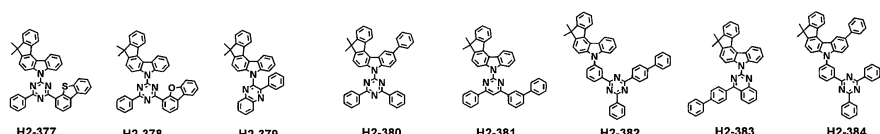
[0117]



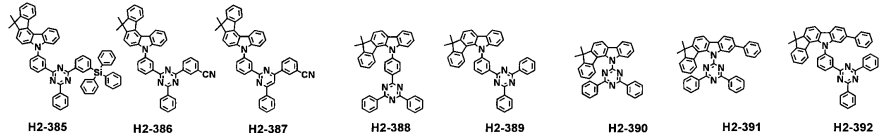
[0118]



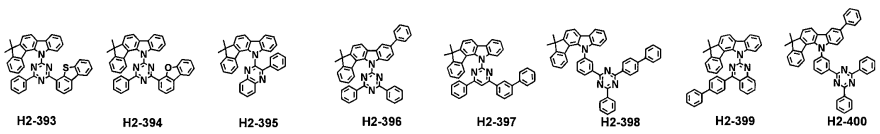
[0119]



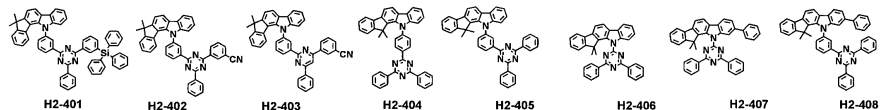
[0120]



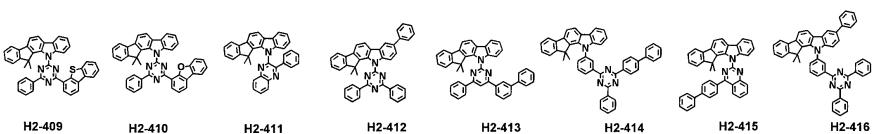
[0121]



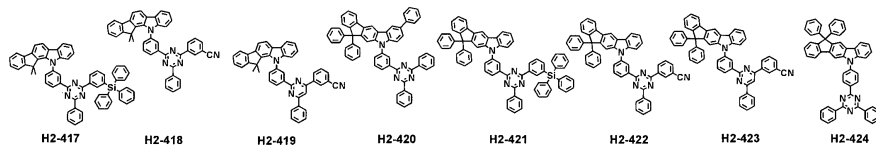
[0122]



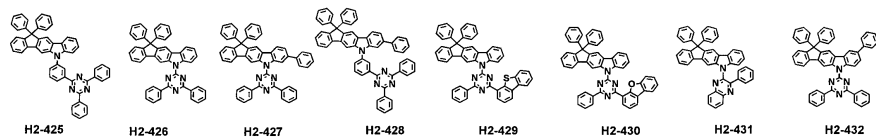
[0123]



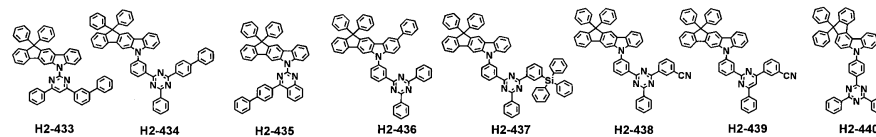
[0124]



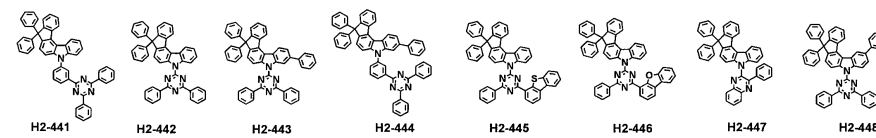
[0125]



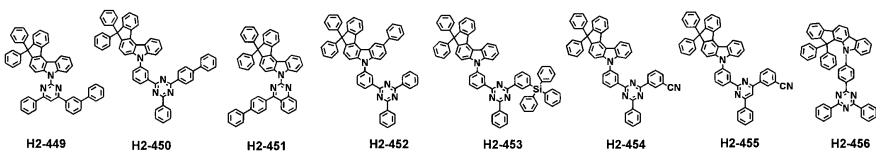
[0126]



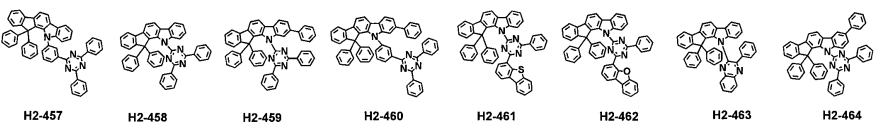
[0127]



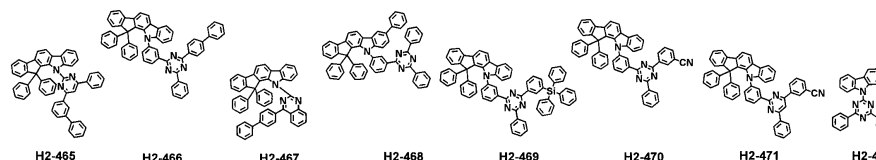
[0128]



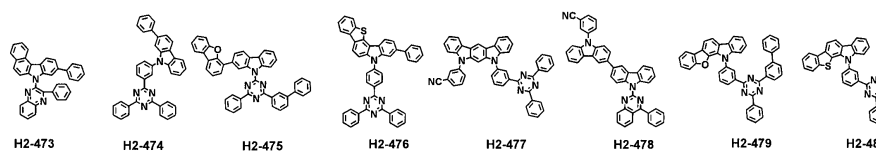
[0129]



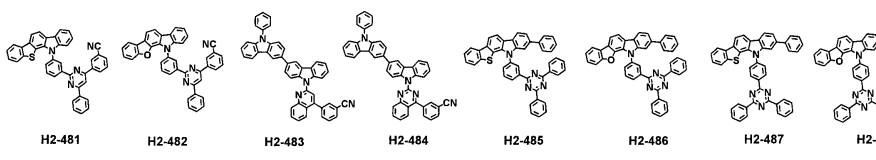
[0130]



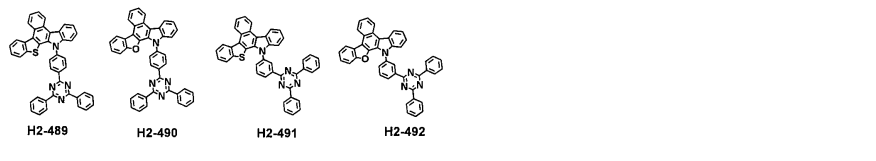
[0131]



[0132]



[0133]

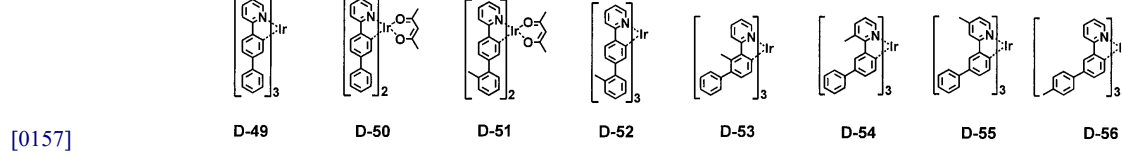
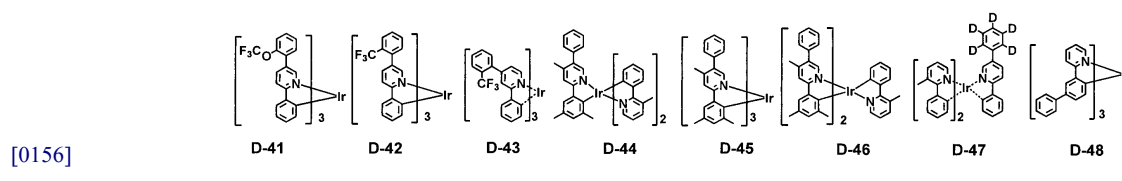
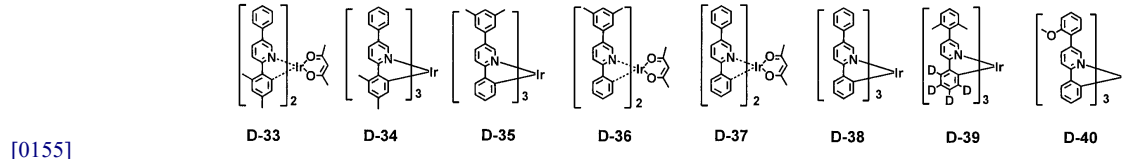
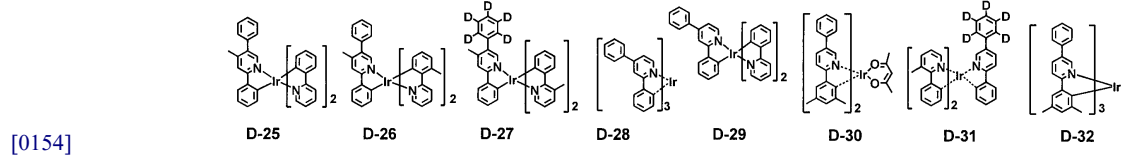
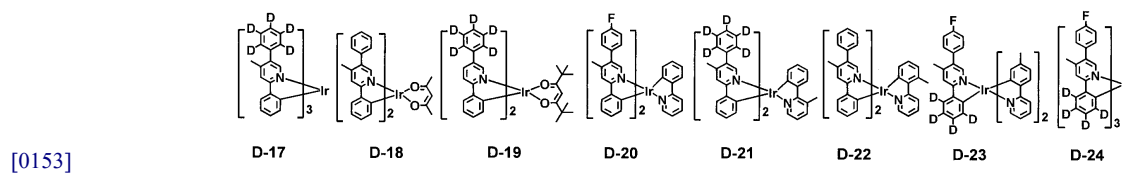
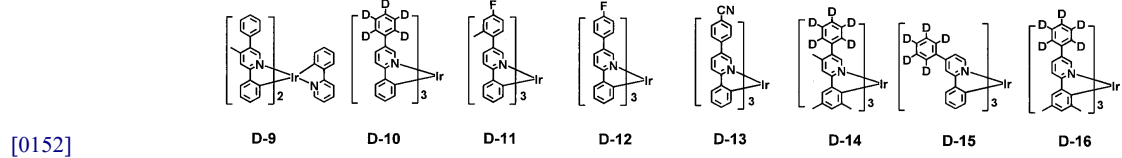
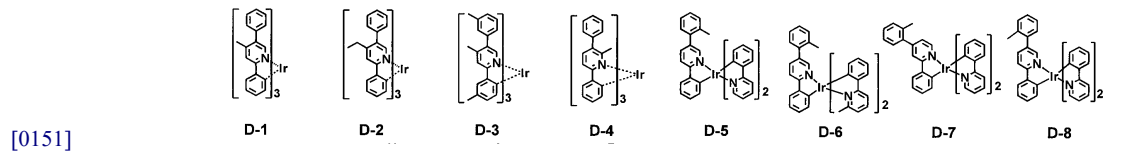


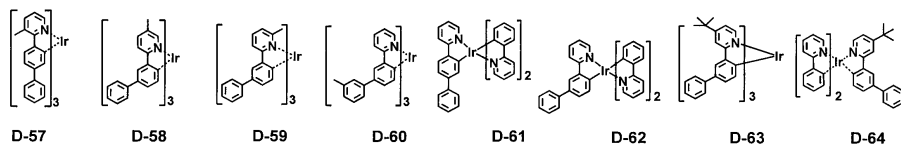
[0147] R_{201} 내지 R_{211} 은 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 할로젠으로 치환 또는 비치환된 (C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된 (C3-C30)시클로알킬, 또는 치환 또는 비치환된 (C6-30)아릴이고, R_{208} 내지 R_{211} 은 인접 치환기가 서로 연결되어 치환 또는 비치환된 융합고리를 형성할 수 있는데, 예를 들어 알킬로 치환 또는 비치환된 플루오렌, 알킬로 치환 또는 비치환된 디벤조티오펜 또는 알킬로 치환 또는 비치환된 디벤조푸란 형성이 가능하며;

[0148] r 및 s 는 각각 독립적으로 1 내지 3의 정수이며, r 또는 s 가 각각 2이상의 정수인 경우 각각의 R_{100} 은 서로 동일하거나 상이할 수 있고;

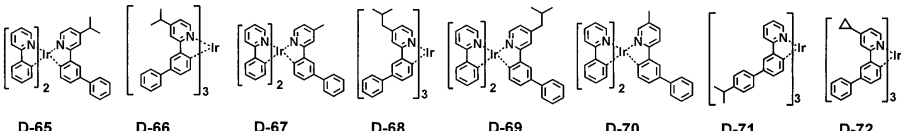
[0149] e 는 1 내지 3의 정수이다.

[0150] 상기 인광 도판트 재료의 구체적인 예로는 다음과 같다.

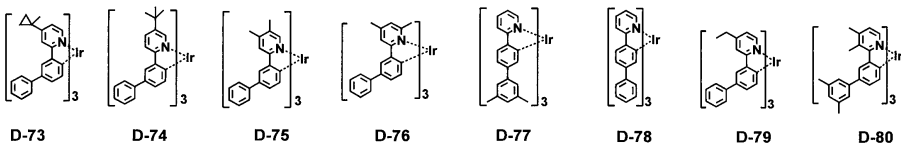




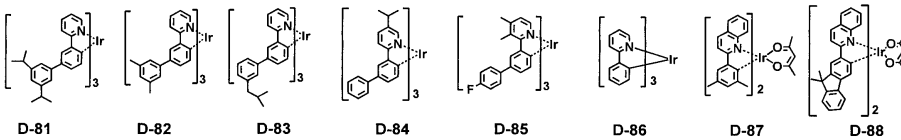
[0158]



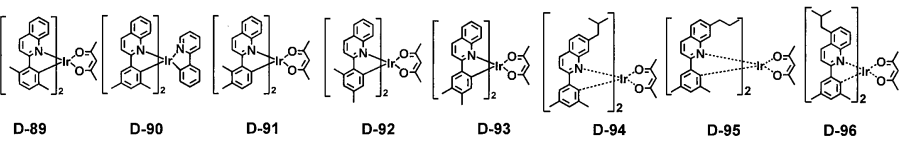
[0159]



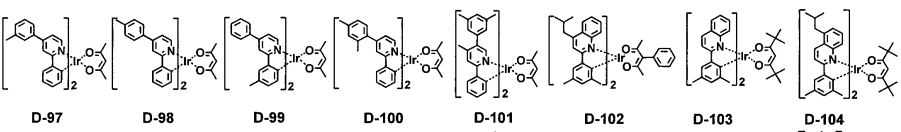
[0160]



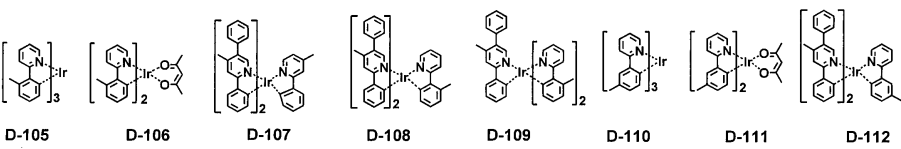
[0161]



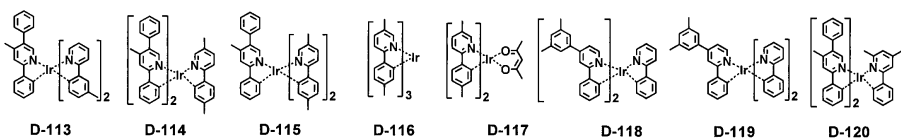
[0162]



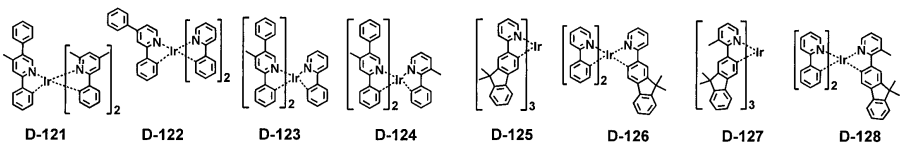
[0163]



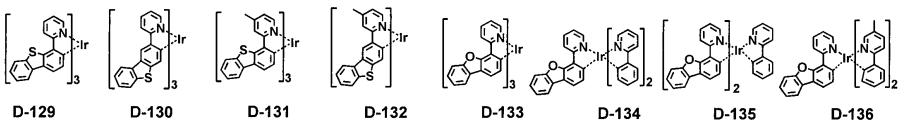
[0164]



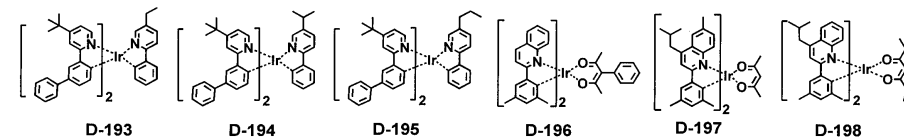
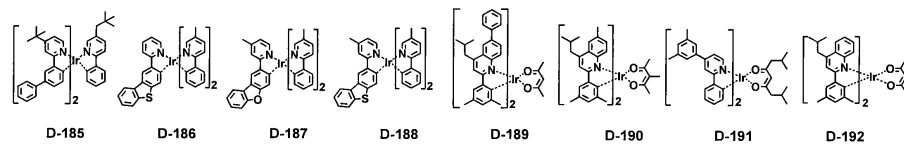
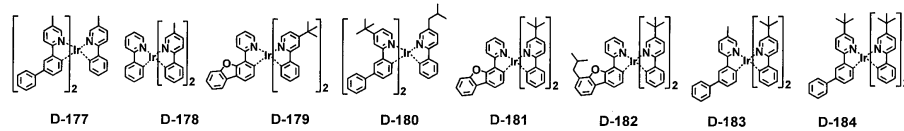
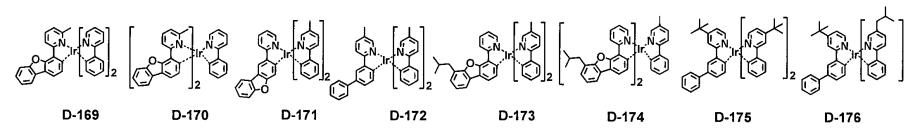
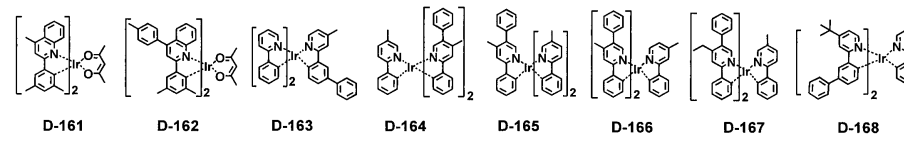
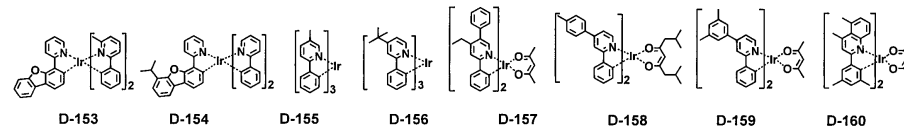
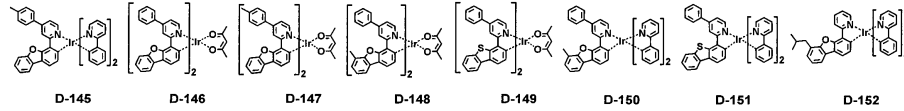
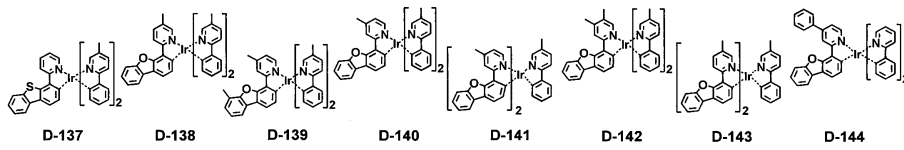
[0165]



[0166]



[0167]



[0176] 본 발명의 유기 전계 발광 소자는 유기물층에 아릴아민계 화합물 및 스티릴아릴아민계 화합물로 이루어진 균으로부터 선택된 하나 이상의 화합물을 추가로 포함할 수도 있다.

[0177] 또한, 본 발명의 유기 전계 발광 소자에 있어서, 유기물층에 1족, 2족, 4주기 전이금속, 5주기 전이금속, 란타계열금속 및 d-전이원소의 유기금속으로 이루어진 균으로부터 선택되는 하나 이상의 금속, 또는 이러한 금속을 포함하는 하나 이상의 착체화합물을 추가로 포함할 수도 있다.

[0178] 본 발명의 유기 전계 발광 소자에 있어서, 한 쌍의 전극의 적어도 한쪽의 내측표면에, 칼코제나이드(chalcogenide)층, 할로겐화 금속층 및 금속 산화물층으로부터 선택되는 하나 이상의 층(이하, 이들을 “표면층”이라고 지칭함)을 배치하는 것이 바람직하다. 구체적으로는, 발광 매체층 측의 양극 표면에 규소 및 알루미늄의 칼코제나이드(산화물을 포함한다)층을, 또한 발광 매체층 측의 음극 표면에 할로겐화 금속층 또는 금속 산화물층을 배치하는 것이 바람직하다. 상기 표면층에 의해 유기 전계 발광 소자의 구동 안정화를 얻을 수 있다. 상기 칼코제나이드의 바람직한 예로는 SiO_x ($1 \leq x \leq 2$), AlO_x ($1 \leq x \leq 1.5$), $SiON$ 또는 $SiAlON$ 등이 있고, 할로겐화

금속의 바람직한 예로는 LiF, MgF₂, CaF₂, 불화 회토류 금속 등이 있으며, 금속 산화물의 바람직한 예로는 Cs₂O, Li₂O, MgO, SrO, BaO, CaO 등이 있다.

[0179] 양극과 발광층 사이에 정공주입층, 정공전달층, 또는 전자차단층에서 선택되거나 이들의 조합으로 이루어진 층이 사용될 수 있다. 정공주입층은 양극에서 정공전달층 또는 전자차단층으로의 정공주입 장벽(또는 정공주입 전압)을 낮출 목적으로 복수의 층이 사용될 수 있으며, 각 층은 2개의 화합물이 동시에 사용될 수 있다. 정공전달층 또는 전자차단층도 복수의 층이 사용될 수 있다.

[0180] 발광층과 음극 사이에 전자버퍼층, 정공차단층, 전자전달층, 또는 전자주입층에서 선택되거나 이들의 조합으로 이루어진 층이 사용될 수 있다. 전자버퍼층은 전자주입을 조절하고 발광층과 전자주입층 사이의 계면 특성을 향상시킬 목적으로 복수의 층이 사용될 수 있으며, 각 층은 2개의 화합물이 동시에 사용될 수 있다. 정공차단층 또는 전자전달층도 복수의 층이 사용될 수 있고, 각 층에 복수의 화합물이 사용될 수 있다.

[0181] 또한, 본 발명의 유기 전계 발광 소자에 있어서, 한 쌍의 전극의 적어도 한쪽의 표면에 전자 전달 화합물과 환원성 도판트의 혼합 영역 또는 정공 전달 화합물과 산화성 도판트의 혼합 영역을 배치하는 것도 바람직하다. 이러한 방식에 의해 전자 전달 화합물이 음이온으로 환원되므로 혼합 영역으로부터 발광 매체에 전자를 주입 및 전달하기 용이해진다. 또한, 정공 전달 화합물은 산화되어 양이온으로 되므로 혼합 영역으로부터 발광 매체에 정공을 주입 및 전달하기 용이해진다. 바람직한 산화성 도판트로서는 각종 루이스산 및 억셉터(acceptor) 화합물을 들 수 있고, 바람직한 환원성 도판트로는 알칼리 금속, 알칼리 금속 화합물, 알칼리 토류 금속, 회토류 금속 및 이들의 혼합물을 들 수 있다. 또한 환원성 도판트층을 전하생성층으로 사용하여 두 개 이상의 발광층을 가진 백색 유기 전계 발광소자를 제조할 수 있다.

[0182] 본 발명의 유기 전계 발광 소자의 각 층의 형성은 진공증착, 스퍼터링, 플라즈마, 이온플레이팅 등의 건식 성막 법이나 스핀 코팅, 침지 코팅(dip coating), 플로우 코팅 등의 습식 성막법 중의 어느 하나의 방법을 적용할 수 있다. 본 발명의 제1 호스트 화합물과 제2 호스트 화합물을 성막할 때, 공증착 또는 혼합증착으로 공정한다.

[0183] 습식 성막법의 경우, 각 층을 형성하는 재료를 에탄올, 클로로포름, 테트라하이드로푸란, 디옥산 등의 적절한 용매에 용해 또는 분산시켜 박막을 형성하는데, 그 용매는 각 층을 형성하는 재료가 용해 또는 분산될 수 있고, 성막성에 문제가 없는 것이라면 어느 것이어도 된다.

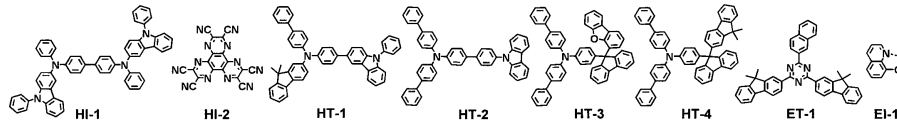
[0184] 또한, 본원 발명의 유기 전계 발광 소자를 이용하여 표시 장치 또는 조명 장치를 제조하는 것이 가능하다.

[0185] 이하에서, 본 발명의 상세한 이해를 위하여 본 발명의 호스트 화합물을 포함하는 소자의 발광특성을 설명한다.

[0186] **[소자 제조예 1-1 내지 1-6] 본 발명에 따른 호스트로서 제1 호스트 화합물 및 제2 호스트 화합물을 공증착한 OLED 소자 제조**

[0187] 본 발명의 유기 전계 발광 화합물을 이용하여 OLED 소자를 제조하였다. 우선, OLED용 글래스(GEOMATEC사 제조)로부터 얻어진 투명 전극 ITO 박막(10Ω/□)을, 트리클로로에틸렌, 아세톤, 에탄올 및 증류수를 순차적으로 사용하여 초음파 세척을 실시한 후, 이소프로판올에 넣어 보관한 후 사용하였다. 다음으로 진공 증착 장비의 기관 홀더에 ITO 기관을 장착한 후, 진공 증착 장비 내의 셀에 N⁴,N^{4'}-디페닐-N⁴,N^{4'}-비스(9-페닐-9H-카바졸-3-일)-[1,1'-비페닐]-4,4'-디아민(화합물 HI-1)을 넣고 챔버 내의 진공도가 10⁻⁶ torr에 도달할 때까지 배기시킨 후, 셀에 전류를 인가하여 증발시켜 ITO 기관 위에 80 nm 두께의 제1 정공 주입층을 증착하였다. 이어서, 진공 증착 장비 내의 다른 셀에 1,4,5,8,9,12-헥사아자트리페닐렌-헥사카르보니트릴(화합물 HI-2)을 넣고, 셀에 전류를 인가하여 증발시켜 제1 정공 주입층 위에 5 nm 두께의 제2 정공 주입층을 증착하였다. 이어서, 진공 증착 장비 내의 다른 셀에 N-([1,1'-비페닐]-4-일)-9,9-디메틸-N-(4-(9-페닐-9H-카바졸-3-일)페닐)-9H-플루오렌-2-아민(화합물 HT-1)을 넣고, 셀에 전류를 인가하여 증발시켜 제2 정공 주입층 위에 10 nm 두께의 제1 정공 전달층을 증착하였다. 이어서, 진공 증착 장비 내의 다른 셀에 N,N-디([1,1'-비페닐]-4-일)-4'-(9H-카바졸-9-일)-[1,1'-비페닐]-4-아민(화합물 HT-2)을 넣고, 셀에 전류를 인가하여 증발시켜 제1 정공 전달층 위에 60 nm 두께의 제2 정공 전달층을 증착하였다. 정공 주입층, 정공 전달층을 형성시킨 후, 그 위에 발광층을 다음과 같이 증착시켰다. 진공 증착 장비 내의 셀 두 군데에 호스트로서 각각 제1 호스트 화합물 및 제2 호스트 화합물을 넣고, 또 다른 셀에는 도판트로서 화합물 D-96을 각각 넣은 후, 두 호스트 물질을 1:1의 같은 속도로 증발시키고 동시에 도판트 물질을 다른 속도로 증발시켜 도판트와 호스트 전체에 대하여 도판트를 3 중량%의 양으로 도핑함으로써 상기

정공 전달층 위에 40 nm 두께의 발광층을 증착하였다. 이어서, 또 다른 셀 두 군데에 2,4-비스(9,9-디메틸-9H-플루오렌-2-일)-6-(나프탈렌-2-일)-1,3,5-트리아진(화합물 ET-1)과 리튬 퀴놀레이트(화합물 EI-1)를 1:1의 같은 속도로 증발시켜 발광층 위에 30 nm 두께의 전자 전달층을 증착하였다. 이어서, 전자 주입층으로 리튬 퀴놀레이트(화합물 EI-1)를 2 nm 두께로 증착한 후, 다른 진공 증착 장비를 이용하여 Al 음극을 80 nm의 두께로 증착하여 OLED 소자를 제조하였다.



[0188]

[비교예 1-1 내지 1-3] 호스트로서 제2 호스트 화합물만 포함하는 OLED 소자 제조

[0189]

발광층의 호스트로서 제2 호스트 화합물만을 사용한 것 외에는 소자 제조예 1-1 내지 1-6과 동일한 방법으로 OLED 소자를 제조하였다.

[0190]

이상과 같이 제조된 유기 전계 발광 소자의 1,000 nit 휘도 기준의 구동 전압, 발광 효율, CIE색좌표와 5,000 nits 휘도 기준 정전류에서 100%부터 80%까지 떨어지는 수명 시간을 측정하였다.

[0191]

상기 소자 제조예에서 제조된 유기 전계 발광 소자의 발광 특성을 하기 표 1에 나타내었다.

[0192]

[0193]

[표 1]

항목	정공전달층	호스트	도판트	전압 [V]	효율 [cd/A]	색좌표 (x,y)	수명 [hr]
제조예 1-1	HT-1 / HT-2	H1-1 : H2-2	D-96	4.4	27.5	0.664, 0.335	1,280
제조예 1-2	HT-1 / HT-2	H1-7 : H2-29	D-96	3.9	27.7	0.665, 0.332	550
제조예 1-3	HT-1 / HT-2	H1-19 : H2-29	D-96	4.1	24.6	0.664, 0.332	470
제조예 1-4	HT-1 / HT-2	H1-36 : H2-154	D-96	4.6	27.8	0.663, 0.335	1,530
제조예 1-5	HT-1 / HT-2	H1-36 : H2-29	D-96	3.7	28.2	0.666, 0.331	780
제조예 1-6	HT-1 / HT-2	H1-36 : H2-155	D-96	4.6	26.9	0.664, 0.335	970
비교예 1-1	HT-1 / HT-2	H2-2	D-96	4.1	28.2	0.662, 0.337	300
비교예 1-2	HT-1 / HT-2	H2-154	D-96	4.5	27.1	0.662, 0.337	420
비교예 1-3	HT-1 / HT-2	H2-29	D-96	3.6	27.5	0.668, 0.331	310

[0194]

[소자 제조예 2-1 내지 2-7] 본 발명에 따른 호스트로서 제1 호스트 화합물 및 제2 호스트 화합물을 공증착한 OLED 소자 제조

[0195]

제2 정공 주입층은 3 nm 두께로 증착하고, 제1 정공 전달층은 40 nm 두께로 증착하고, 제2 정공 전달층은 증착하지 않고, 발광층의 도판트로는 화합물 D-25를 사용하고, 전자 전달층은 2,4-비스(9,9-디메틸-9H-플루오렌-2-일)-6-(나프탈렌-2-일)-1,3,5-트리아진과 리튬 퀴놀레이트를 4:6의 속도로 35 nm 두께로 증착하고, 발광층의 호스트로서 사용된 제1 호스트 화합물 및 제2 호스트 화합물의 조합의 구성을 다르게 한 것 이외에는 소자 제조예 1-1 내지 1-6과 동일한 방법으로 OLED 소자를 제조하였다.

[0196]

[소자 제조예 2-8 내지 2-9] 본 발명에 따른 호스트로서 제1 호스트 화합물 및 제2 호스트 화합물을 공증착한 OLED 소자 제조

[0197]

제2 정공 주입층은 3 nm 두께로 증착하고, 제1 정공 전달층은 40 nm 두께로 증착하고, 제2 정공 전달층은 증착하지 않고, 발광층의 도판트로는 화합물 D-1을 사용하고, 전자 전달층은 2,4-비스(9,9-디메틸-9H-플루오렌-2-일)-6-(나프탈렌-2-일)-1,3,5-트리아진과 리튬 퀴놀레이트를 4:6의 속도로 35 nm 두께로 증착하고, 발광층의 호스트로서 사용된 제1 호스트 화합물 및 제2 호스트 화합물의 조합의 구성을 다르게 한 것 이외에는 소자 제조예 1-1 내지 1-6과 동일한 방법으로 OLED 소자를 제조하였다.

[0198]

- [0199] **[소자 제조예 2-10] 본 발명에 따른 호스트로서 제1 호스트 화합물 및 제2 호스트 화합물을 공증착한 OLED 소자 제조**
- [0200] 제2 정공 주입층은 3 nm 두께로 증착하고, 제1 정공 전달층은 40 nm 두께로 증착하고, 제2 정공 전달층은 증착하지 않고, 발광층의 도판트로는 화합물 D-136을 사용하고, 전자 전달층은 2,4-비스(9,9-디메틸-9H-플루오렌-2-일)-6-(나프탈렌-2-일)-1,3,5-트리아진과 리튬 퀴놀레이트를 4:6의 속도로 35 nm 두께로 증착하고, 발광층의 호스트로서 사용된 제1 호스트 화합물 및 제2 호스트 화합물의 조합의 구성을 다르게 한 것 이외에는 소자 제조예 1-1 내지 1-6과 동일한 방법으로 OLED 소자를 제조하였다.
- [0201] **[소자 제조예 3-1 내지 3-3] 본 발명에 따른 호스트로서 제1 호스트 화합물 및 제2 호스트 화합물을 공증착한 OLED 소자 제조**
- [0202] 제1 정공 주입층은 10 nm 두께로 증착하고, 제2 정공 전달층은 화합물 HT-3을 사용하여 30 nm 두께로 증착하고, 발광층의 도판트로는 화합물 D-136을 사용하고, 발광층의 호스트로서 사용된 제1 호스트 화합물 및 제2 호스트 화합물의 조합의 구성을 다르게 한 것 이외에는 소자 제조예 2-1 내지 2-7과 동일한 방법으로 OLED 소자를 제조하였다.
- [0203] **[소자 제조예 3-4] 본 발명에 따른 호스트로서 제1 호스트 화합물 및 제2 호스트 화합물을 공증착한 OLED 소자 제조**
- [0204] 제1 정공 주입층은 10 nm 두께로 증착하고, 제2 정공 전달층은 화합물 HT-3을 사용하여 30 nm 두께로 증착하고, 발광층의 도판트로는 화합물 D-168을 사용하고, 발광층의 호스트로서 사용된 제1 호스트 화합물 및 제2 호스트 화합물의 조합의 구성을 다르게 한 것 이외에는 소자 제조예 2-1 내지 2-7과 동일한 방법으로 OLED 소자를 제조하였다.
- [0205] **[소자 제조예 3-5] 본 발명에 따른 호스트로서 제1 호스트 화합물 및 제2 호스트 화합물을 공증착한 OLED 소자 제조**
- [0206] 제1 정공 주입층은 10 nm 두께로 증착하고, 제2 정공 전달층은 화합물 HT-3을 사용하여 30 nm 두께로 증착하고, 발광층의 도판트로는 화합물 D-180을 사용하고, 발광층의 호스트로서 사용된 제1 호스트 화합물 및 제2 호스트 화합물의 조합의 구성을 다르게 한 것 이외에는 소자 제조예 2-1 내지 2-7과 동일한 방법으로 OLED 소자를 제조하였다.
- [0207] **[비교예 2-1 내지 2-3] 호스트로서 제1 호스트 화합물만 포함하는 OLED 소자 제조**
- [0208] 발광층의 호스트로서 제1 호스트 화합물만을 사용한 것 외에는 소자 제조예 2-1 내지 2-7과 동일한 방법으로 OLED 소자를 제조하였다.
- [0209] **[비교예 3-1 내지 3-3] 호스트로서 제2 호스트 화합물만 포함하는 OLED 소자 제조**
- [0210] 발광층의 호스트로서 제2 호스트 화합물만을 사용한 것 외에는 소자 제조예 2-1 내지 2-7과 동일한 방법으로 OLED 소자를 제조하였다.
- [0211] **[비교예 3-4 내지 3-6] 호스트로서 제2 호스트 화합물만 포함하는 OLED 소자 제조**
- [0212] 발광층의 호스트로서 제2 호스트 화합물만을 사용한 것 외에는 소자 제조예 2-8 내지 2-9와 동일한 방법으로 OLED 소자를 제조하였다.
- [0213] **[비교예 4-1 내지 4-3] 호스트로서 제2 호스트 화합물만 포함하는 OLED 소자 제조**

[0214] 발광층의 호스트로서 제2 호스트 화합물만을 사용한 것 외에는 소자 제조예 3-1 내지 3-3과 동일한 방법으로 OLED 소자를 제조하였다.

[0215] 이상과 같이 제조된 유기 전계 발광 소자의 1,000 nit 휘도 기준의 구동 전압, 발광 효율, CIE색좌표와 15,000 nits 휘도 기준 정전류에서 100%부터 80%까지 떨어지는 수명 시간을 측정하였다.

[0216] 상기 소자 제조예에서 제조된 유기 전계 발광 소자의 발광 특성을 하기 표 2에 나타내었다.

[0217] [표 2]

항목	정공전달층	호스트	도판트	전압 [V]	효율 [cd/A]	색좌표 (x,y)	수명 [hr]
제조예2-1	HT-1	H1-1 : H2-25	D-25	3.2	49.8	0.301,0.658	350
제조예2-2	HT-1	H1-1 : H2-31	D-25	3	57.1	0.308,0.655	380
제조예2-3	HT-1	H1-1 : H2-48	D-25	2.9	56.8	0.305,0.656	400
제조예2-4	HT-1	H1-1 : H2-101	D-25	3	55.5	0.303,0.657	230
제조예2-5	HT-1	H1-1 : H2-34	D-25	3.1	58.1	0.306,0.655	440
제조예2-6	HT-1	H1-4 : H2-31	D-25	3	53.3	0.304,0.656	120
제조예2-7	HT-1	H1-37 : H2-31	D-25	3	53.7	0.306,0.655	300
제조예2-8	HT-1	H1-1 : H2-31	D-1	2.9	53	0.321,0.656	560
제조예2-9	HT-1	H1-1 : H2-48	D-1	2.8	55.3	0.319,0.657	550
제조예2-10	HT-1	H1-113 : H2-31	D-136	2.8	59.4	0.331,0.655	600
제조예3-1	HT-1 / HT-3	H1-1 : H2-48	D-136	3.1	67.5	0.326,0.658	590
제조예3-2	HT-1 / HT-3	H1-1 : H2-273	D-136	3.1	66.2	0.328,0.657	700
제조예3-3	HT-1 / HT-3	H1-113 : H2-125	D-136	3.1	65.8	0.329,0.657	700
제조예3-4	HT-1 / HT-3	H1-1 : H2-273	D-168	3.0	57.2	0.288,0.665	450
제조예3-5	HT-1 / HT-3	H1-1 : H2-273	D-180	3.0	51.1	0.291,0.664	450
비교예2-1	HT-1	H1-1	D-25	6.8	3.1	0.301,0.653	×
비교예2-2	HT-1	H1-4	D-25	6.6	2.9	0.303, 0.656	×
비교예2-3	HT-1	H1-37	D-25	6.5	2.8	0.303, 0.655	×
비교예3-1	HT-1	H2-31	D-25	2.9	42.8	0.314,0.652	100
비교예3-2	HT-1	H2-101	D-25	2.8	50.3	0.315,0.651	60
비교예3-3	HT-1	H2-34	D-25	2.7	49.2	0.312,0.652	100
비교예3-4	HT-1	H2-31	D-1	2.9	33.5	0.323,0.653	390
비교예3-5	HT-1	H2-48	D-1	2.6	41.2	0.325,0.653	380
비교예3-6	HT-1	H2-87	D-1	2.8	37.9	0.323,0.653	420
비교예4-1	HT-1 / HT-3	H2-48	D-136	2.6	51.9	0.334,0.652	490
비교예4-2	HT-1 / HT-3	H2-125	D-136	3.0	64.9	0.337,0.649	360
비교예4-3	HT-1 / HT-3	H2-273	D-136	3.3	68.2	0.332,0.654	440

[0218]

[0219] [소자 제조예 4-1] 본 발명에 따른 호스트로서 제1 호스트 화합물 및 제2 호스트 화합물을 공중착한 OLED 소자 제조

[0220] 정공 전달층으로서 제2정공 전달층을 화합물 HT-4를 사용하고, 발광층의 호스트로서 하기 표 3의 제1 호스트 화합물 및 제2 호스트 화합물을 사용한 것 외에는 소자 제조예 1-1 내지 1-6과 동일한 방법으로 OLED 소자를 제조하였다.

[0221] [비교예 5-1] 호스트로서 제2 호스트 화합물만 포함하는 OLED 소자 제조

[0222] 발광층의 호스트로서 하기 표 3의 제2 호스트 화합물만을 사용한 것 외에는 소자 제조예 4-1과 동일한 방법으로 OLED 소자를 제조하였다.

[0223] 이상과 같이 제조된 유기 전계 발광 소자의 1,000 nit 휘도 기준의 구동 전압, 발광 효율, CIE색좌표와 5,000 nits 휘도 기준 정전류에서 100%부터 90%까지 떨어지는 수명 시간을 측정하였다.

[0224] 상기 소자 제조예에서 제조된 유기 전계 발광 소자의 발광 특성을 하기 표 3에 나타내었다.

[0225]

[표 3]

항목	정공전달층	호스트	도판트	전압 [V]	효율 [cd/A]	색좌표 (x,y)	수명 [hr]
제조예 4-1	HT-1 / HT-4	H1-7 : H2-41	D-96	3.4	30.7	0.665, 0.333	400
비교예 5-1	HT-1 / HT-4	H2-41	D-96	3.1	28.3	0.668, 0.331	300

[0226]

[0227]

본 발명의 유기 전계 발광 소자는 호스트와 인광 도판트를 포함하는 발광층을 포함하고, 상기 호스트는 특정 조합의 복수종 호스트 화합물로 구성됨으로써, 종래의 소자보다 우수한 수명 특성을 갖는 효과가 있다.

专利名称(译)	多种主体材料和有机电致发光器件		
公开(公告)号	KR101502316B1	公开(公告)日	2015-03-13
申请号	KR1020140087769	申请日	2014-07-11
[标]申请(专利权)人(译)	罗门哈斯电子材料有限公司		
申请(专利权)人(译)	룸엔드하스전자재료코리아유한회사		
当前申请(专利权)人(译)	룸엔드하스전자재료코리아유한회사		
[标]发明人	AHN HEE CHOON 안희춘 KIM YOUNG KWANG 김영광 LEE SU HYUN 이수현 JUN JI SONG 전지송 LEE SEON WOO 이선우 KIM CHI SIK 김치식 PARK KYOUNG JIN 박경진 KIM NAM KYUN 김남균 CHOI KYUNG HOON 최경훈 SHIM JAE HOON 심재훈 CHO YOUNG JUN 조영준 LEE KYUNG JOO 이경주		
发明人	안희춘 김영광 이수현 전지송 이선우 김치식 박경진 김남균 최경훈 심재훈 조영준 이경주		
IPC分类号	C09K11/06 C07D209/82 H01L51/50		
CPC分类号	C07D209/86 C07D209/88 C07D401/04 C07D401/10 C07D401/14 C07D405/14 C07D409/14 C07D487/04 C07D491/04 C07D495/04 C07F15/0033 C09K11/025 C09K11/06 C09K2211/1007 C09K2211/1029 C09K2211/185 H01L51/0061 H01L51/0067 H01L51/0072 H01L51/0073 H01L51/0074 H01L51/0085		

代理人(译) 李昌勋

优先权 1020140046857 2014-04-18 KR

外部链接 [Espacenet](#)

摘要(译)

本发明涉及各种类型的主体材料和包括其的有机电致发光器件，其中有有机电致发光器件包括在正电极和负电极之间的至少一个发光层，并且发光层包括磷光掺杂剂和主体。由各种类型的主体化合物组成。此外，主体化合物中的至少一种主体化合物由化学式1表示。在本发明中，有机电致发光器件具有主体化合物的特定组合，因此具有高发光效率和长期寿命服务。

